การศึกษาผลของการสับและปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศต่อชุดตัวเก็บประจุ ที่สถานีไฟฟ้าย่อยระดับแรงดันปานกลาง

นายอรรถพันธ์ จันทสมิต

สถาบนวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545 ISBN 974-17-2548-5 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY ON CAPACITOR-BANK SWITCHING BY VACUUM SWITCH IN MEDIUM VOLTAGE SUBSTATION

Mr.Attapan Jantasmith

สถาบนวทยบรการ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineer Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2002 ISBN 974-17-2548-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาผลของการสับและปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศต่อชุด
	ตัวเก็บประจุที่สถานีไฟฟ้าย่อยระดับแรงดันปานกลาง
โดย	นายอรรถพันธ์ จันทสมิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์)

.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ หาญบุญญานนท์)

อรรถพันธ์ จันทสมิต : การศึกษาผลของการสับและปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศต่อชุดตัว เก็บประจุที่สถานีไฟฟ้าย่อยระดับแรงดันปานกลาง. (A STUDY ON CAPACITOR-BANK SWITCHING BY VACUUM SWITCH IN MEDIUM VOLTAGE SUBSTATION) อ. ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล, อ. ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์, จำนวนหน้า 118 หน้า. ISBN 974-17-2548-5.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการศึกษาผลการสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุของสถานี ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดแรงดันและกระแสเกินในระบบไฟฟ้าและชุดตัวเก็บประจุ โดยใช้สถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับแรงดัน 22 kV เป็นกรณีศึกษา ซึ่งมีการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับ ผลการจำลองด้วยโปรแกรม EMTP/ATP พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อขนาด แรงดันและกระแสเกินจากการสับและปลดสวิตช์ เช่น ขนาดของตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ จำกัดกระแส เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังวิเคราะห์วิธีการลดแรงดันและกระแสเกินจากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ ได้แก่ การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์, การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์, การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่อ อนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุ และการใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ จากผลการจำลองพบว่าวิธีสุดท้าย สามารถลดแรงดันและกระแสเกินได้มากที่สุด

สำหรับวิธีการลดแรงดันและกระแสเกิน กรณีการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุด ตัวเก็บประจุจะเลือกใช้กับดักฟ้าผ่า โดยพิจารณาตำแหน่งการติดตั้งกับดักฟ้าผ่าที่แตกต่างกัน พบว่าการติดตั้งกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-กราวด์สามารถลดแรงดันเกินที่บัสได้ดีที่สุด ส่วนการ ติดตั้งกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลหรือกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล กราวด์สามารถลดแรงดันเกินที่ชุดตัวเก็บประจุได้ดีที่สุด

4 4 N 10 N 11 3 6 16 4 1 1 3 1 12 10 12

ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2545	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4270652021 : ELECTRICAL ENGINEERING

KEY WORDS : CAPACITOR SWITCHING / TRANSIENTS OVERVOLTAGE / EMTP / ATTAPAN JANTASMITH : A STUDY ON CAPACITOR-BANK SWITCHING BY VACUUM SWITCH IN MEDIUM VOLTAGE SUBSTATION. THESIS ADVISOR : CHANNARONG BALMONGKOL, Dr.Sc.Techn., THESIS COADVISOR : KOMSON PETCHARAKS, Dr.Sc.Techn. 118 pp. ISBN 974-17-2548-5.

This thesis presents a study of capacitor bank switching in substation causing transient overvoltage and overcurrent on system and capacitor bank. The field test from 22 kV PEA system is compared with the simulation results from EMTP/ATP. In addition, the effects of parameters such as capacitor size, current limiting reactor size are investigated.

For closing capacitor banks, some techniques to reduce transient overvoltage and overcurrent, i.e. pre-insertion resistor, pre-insertion inductor, inductor series capacitor bank, and synchronous closing control are studied. The simulation results show that the synchronous closing control can reduce overcurrent and overvoltage better than other methods.

For opening capacitor banks in the case of two-phase restikes, protection with surge arresters in different installations are considered. The simulation results show that the installation of arresters between phase-ground gives the best protection for bus while the installation of arresters between phase-neutral or phase-neutral and neutralground gives the best protection for capacitor banks.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย

	oothour Engineorning	
Field of study <u>E</u>	lectrical Engineering	Advisor's signature
Academic year	2002	Co-advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ได้ให้แนวทางศึกษาวิจัย, การแก้ปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่อง จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนั้น ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร และ คุณพงษ์ศักดิ์ หาญบุญญานนท์ ที่ช่วยตรวจ สอบและแก้ไขวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ <mark>คุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล จาก</mark>บริษัท ABB ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ในด้านข้อมูลและคำแนะนำในการจำลอง

ขอขอบพระคุณ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้าน ข้อมูลและการตรวจวัดที่สถานีไฟฟ้า

ขอขอบพระคุณ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูล ขอขอบพระคุณ คุณถาวร เอื้อดี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการไปตรวจวัดที่สถานีไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยที่ มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยอบรมสั่งสอนและเป็นกำลังใจ รวมทั้งสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆด้านตลอดมา จนประสบผลสำเร็จในที่สุด

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์	 		 		१
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ					୍
กิตติกรรมประกาศ	 		 		นิ
สารบัญ	 	••••	 	••••••	บ
สารบัญตาราง	 		 		J
สารบัญรูป			 		ฏ

บทที่

1. บทน้ำ	1
1.1 บทน้ำทั่วไป	1
1.2 ที่มาของปัญหา	1
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์	2
1.4 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
2. ทฤษฎีแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งจากการสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	4
2.1 ทรานเซี้ยนต์ทางไฟฟ้า	4
2.2 พารามิเตอร์วงจรไฟฟ้า	4
2.3 แรงดันเกินสวิตซิ่ง	6
2.3.1 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	7
2.3.1.1 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว (Isolated bank)	7
2.3.1.2 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ Back-to-Back	10
2.3.2 การปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	13
3. วิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็	บประจุ 16
3.1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ (Pre-insertion resistor)	
3.2 การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ (Pre-insertion inductor)	17
3.3 การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุ	18
3.4 การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ (Synchronous Closing Control)	

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
3.4.1 ต่อแบบวายต่อลงดิน	19
3.4.2 ต่อแบบวายไม่ต่อลงดิน	19
3.5 การใช้กับดักฟ้าผ่าแบบ MOV	20
3.5.1 แรงดันใช้งานต่อเนื่อง (Continuous operating voltage, U _c)	21
3.5.2 แรงดันพิกัด (Rated voltage, U _r)	21
3.5.2.1 กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟล-กราวด์	21
3.5.2.2 กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอล	22
3.5.2.3 กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์	22
3.5.3 ความสามารถในการรับพลังงาน (Energy Absorbtion)	22
4. อุปกรณ์และวิธีการตรวจวัดรูปคลื่นที่สถานีไฟฟ้าย่อย	23
4.1 การตรวจวัดรูปคลื่ <mark>นแรง</mark> ดัน	24
4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดรูปคลื่นแรงดัน	26
5. กรณีศึกษาการสับและ <mark>ปลดส</mark> วิตช์ชุ <mark>ดตัวเก็บประ</mark> จุในสถ <mark>าน</mark> ีไฟฟ้าย่อย	27
5.1 ข้อมูลและแบบจำลอ <mark>งของสถานีไฟฟ้าย่อย</mark>	27
5.1.1 วงจรป้อนของระบบ	28
5.1.1.1 อิมพีแดนซ์ลัดวงจร (Short circuit impedance)	28
5.1.1.2 สายส่งแบบพารามิเตอร์คงที่ (Constant parameter line)	29
5.1.1.3 สา <mark>ย</mark> ส่งแบบพารามิเตอร์ขึ้นกับความถื่	
(Frequency-dependent parameter line)	30
5.1.2 หม้อแปลง	31
5.1.3 ชุดตัวเก็บประจุ	32
5.1.4 ตัวเหนี่ยวนำ	33
9 5.1.5 โหลดของสถานีไฟฟ้า	33
5.2 การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจวัดกับการจำลองด้วยโปรแกรม EMTP/ATP	33
5.3 ผลของพารามิเตอร์ต่างๆในวงจรเมื่อสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	46
5.3.1 มุมที่สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	46
5.3.2 ขนาดของอิมพีแดนซ์ลัดวงจรของระบบ	49
5.3.3 ขนาดของอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่ง	50

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
5.3.4 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำ	51
5.3.5 ขนาดของชุดตัวเก็บประจุ	53
5.3.6 ขนาดของโหลด	54
5.4 ผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรเมื่ <mark>อปล</mark> ุดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	57
5.4.1 ขนาดของอิมพีแดนซ์ลั <mark>ดวงจรขอ</mark> งระบบ	58
5.4.2 ขนาดของอิม <mark>พีแดนซ์เสิร์จ</mark> ของสายส่ง	60
5.4.3 ขนาดของ <mark>ตัวเหนี่ยวนำ</mark>	62
5.4.4 ขนาดของชุ <mark>ดตัวเ</mark> ก็บประจุ	64
5.4.5 ขนาดของโ <mark>หลด</mark>	66
6. การศึกษาวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับและปลดสวิตช์	
ชุดตัวเก็บประจุของกรณีศึกษา	70
6.1 การควบคุมแรง <mark>ดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการ</mark> สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	70
6.1.1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ (Pre-insertion resistor)	70
6.1.2 การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ (Pre-insertion inductor)	72
6.1.3 การใช้ตัวเหนี่ <mark>ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประ</mark> จุ	73
6.1.4 การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ (Synchronous Closing Control)	74
6.1.5 เปรียบเที <mark>ยบผลการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิ</mark> ตชิ่งด้วยวิธีการต่างๆ	76
6.2 การควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	87
6.2.1 กับดักฟ้าผ่าแบบ MOV	87
6.2.1.1 เปรียบเทียบการติดตั้งกับดักฟ้าผ่าในรูปแบบต่าง ๆ	89
6.2.1.2 เปรียบเทียบขนาดแรงดันพิกัดของกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างนิวทรอล-กรา	າวด์91
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	93
7.1 สรุปผลการวิจัย	93
7.2 ข้อเสนอแนะ	95
รายการอ้างอิง	96
ภาคผนวก	99
ก. วิธีการหาสมการแรงดันเกินสวิตซิ่งและกระแสเกินสวิตซิ่ง	100
ก.1 วิธีหาสมการแรงดันเกินสวิตชิ่งและกระแสเกินสวิตชิ่งจากรูปที่ 2.1	100

สารบัญ(ต่อ)

บทที่ หน้
ก.2 วิธีหาสมการแรงดันเกินสวิตชิ่งและกระแสเกินสวิตชิ่งจากรูปที่ 2.3 103
ข. ข้อมูลที่ใช้ในการจำลอง 109
ข.1 ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร
ข.2 ค่าซีแควนซ์ของสายส่ง
ข.3 ลักษณะการจัดวางส <mark>ายส่ง</mark>
ข.4 ข้อมูลของหม้อแปลง
ข.5 ข้อมูลของกับดักฟ้าผ่า
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตาร	างที่	หน้า
5.1	ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร	29
5.2	พารามิเตอร์ของสายส่ง	29
5.3	ค่าพารามิเตอร์โหลดที่ใช้ในการจำลอง	33
5.4	เปรียบเทียบแรงดันเกินสวิตชิ่ง (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	34
5.5	เปรียบเทียบกระแสเกินสวิต <mark>ชิ่ง (สับ</mark> สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	34
5.6	เปรียบเทียบแรงดันเกินสวิตชิ่ง (ปลดสวิตช์ชุ <mark>ดตัวเก็บปร</mark> ะจุชุดที่ 1)	37
5.7	เปรียบเทียบแรงดัน <mark>เกินสวิตชิ่ง (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุ</mark> ดที่ 3)	40
5.8	เปรียบเทียบกระแสเกินสวิตชิ่ง (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	40
5.9	เปรียบเทียบแรงดั <mark>นเกินสวิตชิ่ง (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุด</mark> ที่ 3)	43

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญรูป

<u>รู</u> ปที่	หน้า
2.1 วงจรสมมูลชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว	7
2.2 วงจรสมมูลชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว(ไม่พิจารณาค่าความต้านทาน)	9
2.3 วงจรสมมูลชุดตัวเก็บประจุแบบ Back to Back	10
2.4 วงจรสมมูลการปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ	13
2.5 รูปคลื่นกระแสและแรงดันเมื่อเกิดอาร์กที่แรงดันค่ายอด	14
2.6 รูปคลื่นแรงดันเมื่อเกิดอาร์กซ้ำหลายครั้ง	15
3.1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์	
3.2 การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์	17
3.3 การต่อชุดตัวเก็บประจุ	
3.4 ภาพแสดงเวลาในการสับสวิตช์	20
4.1 แบบผังสถานีไฟฟ้าย่อย	
4.2 ตำแหน่งติดตั้งโวลเตจ <mark>ด</mark> ิไวเดอร์	24
4.3 การติดตั้งโวลเตจดิไวเดอร์	25
4.4 วงจรการตรวจวัดแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุ	25
4.5 อุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกรูปคลื่น	
5.1 แบบจำลองสถานีไฟฟ้า	27
5.2 ผังวงจรป้อนของระบบ	
5.3 วงจรป้อนแทนด้ว <mark>ย</mark> สายส่งแบบพารามิเตอร์คงที่	30
5.4 วงจรป้อนแทนด้วยสายส่งแบบพารามิเตอร์ขึ้นกับความถี่	
5.5 วงจรสมมูลของหม้อแปลง	
5.6 การต่อตัวเก็บประจุแบบดับเบิ้ลวายไม่ต่อลงดิน	32
5.7 รูปคลื่นแรงดันที่จุด P1 (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	
5.8 รูปคลื่นแรงดันที่จุด P2 (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	35
5.9 รูปคลื่นแรงดันที่จุด P34 (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	
5.10 รูปคลื่นกระแสที่จุด C34 (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	
5.11 รูปคลื่นแรงดันที่จุด P2 (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	
5.12 รูปคลื่นแรงดันที่จุด P34 (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	
5.13 รูปคลื่นแรงดันที่จุด P4 (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)	39

รูปที่		หน้า
5.14	รูปคลื่นแรงดันที่จุด P1 (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	. 41
5.15	รูปคลื่นแรงดันที่จุด P2 (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	. 41
5.16	รูปคลื่นแรงดันที่จุด P34 (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	. 42
5.17	รูปคลื่นกระแส (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	. 42
5.18	รูปคลื่นแรงดันที่จุด P2 (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	. 44
5.19	รูปคลื่นแรงดันที่จุด P34 (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	. 44
5.20	รูปคลื่นแรงดันที่จุด P4 (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)	. 45
5.21	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนมุมสับสวิตช์	. 47
5.22	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนมุมสับสวิตช์	. 47
5.23	กระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนมุมสับสวิตช์	. 47
5.24	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์	. 49
5.25	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุ <mark>ดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาด</mark> อิมพีแดนซ์	. 49
5.26	กระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุ <mark>ดเมื่</mark> อเป <mark>ลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์</mark>	. 50
5.27	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุ <mark>ดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอ</mark> ิมพีแด _{นซ์เสิร์จ}	. 50
5.28	แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ	. 51
5.29	กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ	. 51
5.30	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวน้ำ	. 52
5.31	แรงดันเกินสวิตซิ่งสู _้ งสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนา <mark>ดตั</mark> วเหนี่ยวนำ	. 52
5.32	กระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวน้ำ	. 52
5.33	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ	. 53
5.34	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ	. 53
5.35	กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ	. 54
5.36	о แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8)	. 54
5.37	แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9)	. 55
5.38	แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8)	. 55
5.39	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9)	. 55
5.40	กระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8)	. 56
5.41	กระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9)	. 56

รูปที่ ห	น้า
5.42 แรงดันคร่อมสวิตช์เมื่อเฟส A และเฟส C เกิดอาร์กซ้ำ	57
5.43 แรงดันคร่อมตัวชุดเก็บประจุเมื่อเฟส A และเฟส C เกิดอาร์กซ้ำ	57
5.44 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส A)	58
5.45 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส A)	58
5.46 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส C)	59
5.47 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุ <mark>ดที่ชุดตัวเก็</mark> บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส C)	59
5.48 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส A)	60
5.49 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส A)	60
5.50 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส C)	61
5.51 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส C)	61
5.52 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ (เฟส A)	62
5.53 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ (เฟส A)	62
5.54 แรงดันเกินสวิตชิ่งสู <mark>งสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยว</mark> นำ (เฟส C)	63
5.55 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุ <mark>ดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเป</mark> ลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ (เฟส C)	63
5.56 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (เฟส A)	64
5.57 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (เฟส A)	64
5.58 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (เฟส C)	65
5.59 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนา <mark>ด</mark> ชุดตัวเก็บประจุ (เฟส C)	65
5.60 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8) (เฟส A)	66
5.61 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9)(เฟส A)	66
5.62 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8) (เฟส A)	66
5.63 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9) (เฟส A)	67
5.64 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.8	67
5.65 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.9	68
5.66 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.8	68
5.67 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.9	68
6.1 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อใช้ตัวต้านทานขนาดต่างๆ	71
6.2 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อใช้ตัวต้านทานขนาดต่างๆ	71

ลูปที่	หน้า
6.3 กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อใช้ตัวต้านทานขนาดต่างๆ	71
6.4 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อใช้ตัวเหนี่ยวนำขนาดต่างๆ	72
6.5 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อใช้ตัวเหนี่ยวนำขนาดต่างๆ	72
6.6 กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อใช้ตัวเหนี่ยวน้ำขนาดต่างๆ	73
6.7 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อใช้ขนาดตัวเหนี่ยวน้ำต่างๆ	73
6.8 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อใช้ขนาดตัวเหนี่ยวนำต่างๆ	74
6.9 กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อใช้ขนาดตัวเหนี่ยวนำต่างๆ	74
6.10 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนต่างๆ	75
6.11 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนต่างๆ	75
6.12 กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนต่างๆ	76
6.13 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัส	76
6.14 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุ	77
6.15 กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุด	77
6.16 รูปคลื่นแรงดันที่บัสจากวิธีก <mark>ารควบคุมแรงดันแล</mark> ะกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ	
ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บป <mark>ระจุชุดที่</mark> 1	78
6.17 รูปคลื่นแรงดันที่บัสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ	
ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2	79
6.18 รูปคลื่นแรงดันที่บัสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเก [ิ] นสวิตชิ่งต่างๆ	
ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3	80
6.19 รูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ	
ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1	81
6.20 รูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ	
ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2	82
6.21 รูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งต่างๆ	
ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3	83
6.22 รูปคลื่นกระแสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ	
ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1	84

รูปที่		หน้า
6.23	รูปคลื่นกระแสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ	
	ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2	85
6.24	รูปคลื่นกระแสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ	
	ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3	86
6.25	วงจรในกรณีกับดักฟ้าผ่าต่อแบบเฟส-กราวด์	88
6.26	วงจรในกรณีกับดักฟ้าผ่าต่อแบบเฟส-นิวทร _ั อล	88
6.27	วงจรในกรณีกับดัก <mark>ฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและน</mark> ิวทรอล-กราวด์	88
6.28	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุ <mark>ด</mark> ที่บัส	90
6.29	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุ	90
6.30	แรงดันเกินสวิตซิ่งสู _่ งสุ <mark>ดที่บัส</mark>	91
6.31	แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุ	92

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำทั่วไป

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศนั้นนับวันจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าต้องหาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าเพื่อให้เพียง พอกับความต้องการ ซึ่งอุปกรณ์และโหลดส่วนใหญ่มักเป็นจำพวกตัวเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดค่าตัว ประกอบกำลังล้าหลัง ส่งผลให้ระบบมีกำลังงานไฟฟ้าลดลง, พลังงานสูญเสียในระบบเพิ่มขึ้น, แรงดันของระบบลดลง เป็นต้น วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า ให้ดีขึ้นคือ การใช้ชุดตัวเก็บประจุ (Capacitor Bank) เนื่องจากชุดตัวเก็บประจุช่วยชดเซยกำลัง รีแอคทีฟที่ระบบสูญเสียไปได้ นอกจากนั้นวิธีการดังกล่าวยังมีข้อดีหลายประการ เช่น ระบบจ่าย กำลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น, ควบคุมแรงดันในระบบจำหน่าย, ปรับปรุงความมั่นคงของแรงดัน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วตัวเก็บประจุจะมีการติดตั้งที่สายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย สำหรับชุดตัวเก็บ ประจุที่สถานีไฟฟ้าย่อยส่วนใหญ่จะติดตั้งตัวเก็บประจุเล็กหลาย ๆ ชุดแทนที่จะเป็นชุดใหญ่เพียง ชุดเดียว เนื่องจากสามารถชดเซยกำลังรีแอคทีฟและระดับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตามระดับโหลดที่ เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า

เนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันมีความต้องการไม่คงที่ จึงเป็นเหตุให้มี การสับและปลดชุดตัวเก็บประจุด้วยสวิตช์หลายครั้งตามปริมาณความต้องการของโหลดในแต่ละ ช่วงเวลาของวัน โดยการสวิตช์ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการสับหรือปลดสวิตช์จะทำให้เกิดแรงดัน เกินชั่วครู่ (Transients Overvoltage) ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา เช่น อุปกรณ์เกิดชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนกำหนด, อุปกรณ์ควบคุมเสียหาย หรือเกิดความต่าง ศักย์กราวด์สูง เป็นต้น

1.2 ที่มาของปัญหา

การสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุทั้งการสับและปลดสวิตช์ที่ชุดตัวเก็บประจุในสถานีไฟฟ้าย่อย ส่งผลกระทบต่อสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดทรานเซี้ยนต์ (Transient) ในลักษณะ ต่างๆ โดยในกรณีของการสับสวิตช์จะเกิดแรงดันเกินหรือกระแสเกินที่เรียกว่า กระแสพุ่งเข้า (Inrush current) อาจเป็นเหตุให้ฟิวส์ของชุดตัวเก็บประจุขาดหรือทำให้ชุดตัวเก็บประจุเสียหายได้ ส่วนในกรณีของการปลดสวิตช์ จะเกิดเหตุการณ์แรงดันเกินเนื่องจากอาร์กซ้ำ(Restrike) ที่ชุดตัว เก็บประจุเองทำให้ชุดตัวเก็บประจุได้รับความเสียหาย เป็นเหตุให้ชุดตัวเก็บประจุส่วนนั้นหรือทั้ง สถานีไฟฟ้าย่อยไม่สามารถทำงานต่อไปได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผลกระทบของการ สับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุเป็นเหตุให้ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าต้องสูญเสียทั้งเวลาและ งบประมาณในการจัดหาฟิวส์และชุดตัวเก็บประจุมาเปลี่ยน รวมทั้งต้องสูญเสียพลังงานไปเนื่อง จากไม่สามารถใช้งานชุดตัวเก็บประจุมาช่วยเพิ่มค่าตัวประกอบกำลังได้

วิทยานิพนธ์นี้ จะทำการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของชุดตัวเก็บประจุ,ขนาดของตัว เหนี่ยวนำ,ขนาดอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่าย ซึ่งมีผลต่อชุดตัวเก็บประจุในสถานีไฟฟ้าที่เกิดจากการ สับและปลดสวิตซ์ โดยจะทำการสร้างแบบจำลองเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม Electromagnetic Transient Program (EMTP) ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองกับค่าที่ตรวจวัด ได้จริงที่สถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อที่จะได้แบบจำลองที่มีความเหมาะสม

1.3 ขอบเขตของวิทย<mark>านิพนธ์</mark>

- หาค่าของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อชุดตัวเก็บประจุจากการสับและปลดสวิตช์ชนิด สูญญากาศที่สถานีไฟฟ้าย่อย อันได้แก่ ขนาดความจุไฟฟ้าของชุดตัวเก็บประจุ, ขนาดตัวเหนี่ยวนำ เป็นต้น
- 2. สร้างแบบจำลองเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม EMTP
- สึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสับและปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศต่อชุดตัวเก็บประจุ ที่สถานีไฟฟ้าย่อย เช่น ขนาดของชุดตัวเก็บประจุ , ขนาดอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่าย เป็นต้น
- ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากกระแสพุ่งเข้าขณะสับสวิตช์ชนิดสูญญากาศและ การเกิดอาร์กซ้ำขณะปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศ

1.4 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

- ศึกษาทฤษฏีและการใช้โปรแกรม EMTP และหาค่าของพารามิเตอร์ต่างๆที่มีผลต่อชุด ตัวเก็บประจุจากการสับและปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศที่สถานีไฟฟ้าย่อย อันได้แก่ ขนาดความจุไฟฟ้าของชุดตัวเก็บประจุ, ขนาดตัวเหนี่ยวน้ำ เป็นต้น
- 2. สร้างแบบจำลองขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม EMTP
- 3. ทำการวัดข้อมูลจริงที่สถานีไฟฟ้าย่อยและทำการเปรียบเทียบผลกับแบบจำลอง
- 4. ศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อชุดตัวเก็บประจุเช่น ขนาดของชุดตัวเก็บ ประจุ , ขนาดอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่าย เป็นต้น

- ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากกระแสพุ่งเข้าขณะสับสวิตช์ชนิด สูญญากาศและการเกิดอาร์กซ้ำขณะปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศ
- 6. สรุปและเขียนวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถอธิบายสาเหตุและผลของพารามิเตอร์ต่างๆที่มีผลต่อชุดตัวเก็บประจุที่สถานีไฟ ฟ้าย่อยได้และศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์, การติดตั้งกับดักเสิร์จ เป็นต้น เพื่อนำแนวทางที่ได้ไปแก้ไขปัญหาเนื่องจากกระแสพุ่งเข้าขณะสับ สวิตช์ชนิดสูญญากาศและการเกิดอาร์กซ้ำขณะปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศ



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทฤษฎีแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งจากการสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

การศึกษาแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งนั้น เราจำเป็นต้องทราบถึงความหมายและหลัก การพื้นฐานของการเกิดทรานเซี้ยนต์ทางไฟฟ้า (Electrical Transient) เสียก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจ ถึงปัญหาและที่มาของการเกิดทรานเซี้ยนต์ทางไฟฟ้า และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ในบทนี้อธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสับและปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุและหา สมการพื้นฐานในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจาการสับและปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุ

2.1 ทรานเซี้ยนต์ทาง<mark>ไฟฟ้า</mark>

ทรานเซี้ยนต์ทางไฟฟ้า [1] คือ การเปลี่ยนแปลงค่าทางแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า คย่างกระทันหันและรวดเร็ว คันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอย่างทันทีทันใดในวงจร เช่น การเปิดหรือปิดสวิตช์ หรือเกิดผิดพร่อง (fault) ขึ้นในระบบ ช่วงเวลาการเกิดทรานเซี้ยนต์จะมีช่วง ้สั้นมาก ซึ่งช่วงระยะเวล<mark>า</mark>สั้น ๆ เช่นนั้น ในสถาวะคงตัว (steady state) หรือสถาวะทำงานปกติจะ ไม่มีความหมายหรือความสำคัญเลย แต่ในช่วงเวลาของการเกิดทรานเซี้ยนต์จะมีความสำคัญ ้อย่างยิ่งเพราะในช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวนั้นองค์ประกอบต่างๆ ของวงจรจะได้รับความเครียด (stress) ทั้งทางไฟฟ้าและทางกลสูงมาก อันเป็นผลจากแรงดันหรือกระแสที่มีค่าสูงกว่าค่าแรงดัน ระบบใช้งานหรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ เราเรียกแรงดันหรือกระแสนี้ว่า แรงดันเกิน (overvoltage) หรือกระแสเกิน (overcurrent) โดยแรงดันเกินสามารถแบ่งตามลักษณะของต้นกำเนิดได้ 2 ประเภท ประเภทแรกมาจากในบรรยากาศ คือ ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า ซึ่งเกิดจากภายนอกระบบจึง เรียกว่า แรงดันเกินภายนอก (external overvoltage) ประเภทที่สองเกิดจากภายในระบบเอง อัน เนื่องจากการทำงานปิดหรือเปิดวงจร หรือเกิดจากการผิดพร่องในระบบ ซึ่งเรียกว่า แรงดันเกินภาย ้แรงดันเกินภายในยังอาจแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแรงดันเกินสวิตซิ่ง ใน (internal overvoltage) (switching overvoltage) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นมีลักษณะเป็นทรานเซี้ยนต์หน่วง และอีกรูป แบบหนึ่งเป็นแรงดันเกินชั่วคราว (temporary overvoltage) ซึ่งมีลักษณะเป็นออสซิลเลชั่นที่ ความถี่พลังงานหรือเป็นฮาร์มอนิกส์

2.2 พารามิเตอร์วงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์ในระบบหรือโรงงานโดยทั่วไปจะสามารถแทนด้วยพารามิเตอร์วงจรไฟฟ้าได้ 3 รูป แบบ [1] ดังนี้

ความต้านทาน
$$R = \frac{\rho \ell}{A}$$
 (Ω)
 ความเหนี่ยวนำ $L = \frac{\Psi}{I}$ (H)
 ความจุไฟฟ้า $C = \frac{\epsilon A}{d}$ (F)

เมื่อ

- ρ = ความต้านทานจำเพาะ (Ω.m)
- ε = เปอร์มิตติวิตี้ (F/m)
- ℓ = ความยาว (m)
- A = พื้นที่ภาคตัดขวางหรือพื้นที่อิเล็กโทรด (m²)
- d = ความหนาหรือระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด
- ψ = เส้นฟลักซ์คล้องเกี่ยว
- I = กระแสไฟฟ้า (A,rms)

ตารางที่ 2.1 พารามิเตอร์ของวงจร

พารามิเตอร์	สัญญูฉักษณ์	แรงคันตกกร่อม	พลังงานในพารามิเคอร์
กวามต้านทาน R (Ω)		$U_R = IR$	W _R = l ² R สูญเสียกระจายไป
กวามเหนี่ยวนำ L (H, mH, µH)		$U_{L} = L \frac{di}{dt}$	W _L = 1/2 LI ² เก็บในรูปสนามแม่เหล็ก ⊕ H
กวามจุไฟฟ้า C (ก่าเก็บประจุ) (F, μF, pF)		$U_{c} = Q/C$ = I/jwC $\frac{dU_{c}}{dt} = \frac{1}{C} \frac{Q}{dt}$	W _c = 1/2 CU ² เก็บอยู่ในรูปสนามไฟฟ้

การเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติไปสู่ทรานเซี้ยนต์ทางไฟฟ้า จะทำให้วงจรต้องมีการ กระจายพลังงานปรับไปอยู่ในสภาวะใหม่ แต่การกระจายพลังงานใหม่นี้จะเกิดขึ้นทันทีทันใดไม่ได้ เนื่องจาก ความเหนี่ยวนำ (L) สามารถเก็บพลังงานไว้ได้ในรูปสนามแม่เหล็กคือ ¹/₂Ll² แต่พลัง งานเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีไม่ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงพลังงานสนามแม่เหล็กต้องมีการ เปลี่ยนแปลงของกระแส แต่ตามกฏ Lenz's law กระแสเปลี่ยนแปลงทันทีในความเหนี่ยวนำไม่ได้ เนื่องจากเกิดแรงดันเหนี่ยวนำ L^{di}/_{dt} ต้านการเปลี่ยนแปลง นั้นคือกระแสจะเปลี่ยนแปลงทันที ทันใดในความเหนี่ยวนำไม่ได้

2. ความจุไฟฟ้า (C) สามารถเก็บพลังงานได้ในรูปสนามไฟฟ้าคือ $\frac{1}{2}$ CU² แต่การเปลี่ยน แปลงพลังงานสนามไฟฟ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ จาก U = $\frac{Q}{C}$ นั้นคือ $\frac{du}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = \frac{i}{C}$

ฉะนั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงแรงดันทันทีทันใดได้ต้องมีกระแสค่าอนันต์ไหลในวงจร ซึ่ง เป็นไปไม่ได้หรือกล่าวง่าย ๆ จากความสัมพันธ์ U = Q/C จะเห็นได้ว่าจะมีแรงดันคร่อม C ก็ต่อเมื่อ มีประจุก่อน นั้นคือ แรงดันคร่อมความจุไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไม่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พลังงานเก็บในสนามไฟฟ้าทันทีทันใดไม่ได้

 ความต้านทาน (R) เป็นพารามิเตอร์ที่ทำให้เกิดพลังงานสูญเสียคือ I²R เนื่องจากพลัง งานรวมต้องไม่สูญหาย เพียงแต่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานรูปอื่น

2.3 แรงดันเกินสวิตซิ่ง

แรงดันเกินสวิตซิ่ง [1] จัดเป็นแรงดันเสิร์จหรือทรานเซี้ยนต์ที่เกิดจากการทำงานของ อุปกรณ์ตัดต่อวงจรตามที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้กระทำ หรือเกิดจากการทำงานของสวิตซ์ตัดตอนโดย อัตโนมัติ เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อขจัดการผิดพร่องที่เกิดขึ้นในระบบ เป็นต้น แรงดันเกินสวิตซิ่ง มีขนาดต่ำกว่าแรงดันเกินฟ้าผ่า คือมีโอกาสเกิดสูงประมาณ 4 เท่าของค่ายอดแรงดันเฟสของ ระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของระบบกำลังไฟฟ้าลัดวงจร,ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์ และโหลดของวงจรที่สวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องตัดต่อ

แรงดันเสิร์จหรือทรานเซี้ยนต์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าทางไฟฟ้าอย่างกระทันหัน รวดเร็วและมีช่วงระยะเวลาการเกิดอยู่สั้นมากเมื่อเทียบกับสภาพเวลาทำงานปกติ ค่าไฟฟ้าที่ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่สำคัญก็คือ แรงดันและกระแส ซึ่งค่าทรานเซี้ยนต์ที่เกิดขึ้นทั้งสองจะมีค่าสูง เกินกว่าค่าปกติหลายเท่าตัว เป็นแรงดันเกิน Δu หรือกระแสเกิน Δi เมื่อเกิดอย่างหนึ่ง(Δu, Δi) จะทำให้อีกอย่างหนึ่งเกิดตามมา (Δu, Δi) แม้ว่าช่วงการเกิดจะสั้นมาก แต่ก็มีความหมายและ สำคัญมาก เพราะการฉนวนและองค์ประกอบในระบบจะได้รับความเครียดสนามไฟฟ้า(E) และ กระแสสูงมาก ซึ่งจะยังผลให้เกิดความเสียหายได้ แรงดันเกินสวิตซิ่งมีหลากหลายรูปแบบเช่น แรงดันเกินจากการสับสวิตซ์บนสายส่ง, แรง ดันเกินจากสวิตซ์ตัดวงจรที่เกิดการผิดพร่อง, แรงดันเกินจากสวิตซ์ตัดวงจรกระแส(Current chopping) ,แรงดันเกินเนื่องจากการสับและปลดชุดตัวเก็บประจุ เป็นต้น ในการวิเคราะห์ผลจาก แรงดันเกินสวิตซิ่ง ที่มีผลกระทบต่อชุดตัวเก็บประจุที่สถานีไฟฟ้าย่อยนี้ จะกล่าวถึงแรงดันเกินเนื่อง จากการสับและปลดชุดตัวเก็บประจุ ซึ่งสามารถเป็นออกเป็น 2 กรณีคือ

2.3.1 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

การสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุจะพิจารณาตามจำนวนชุดตัวเก็บประจุที่จะทำการสับสวิตซ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

2.3.1.1 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว (Isolated bank)

เป็นการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุเพียงชุดเดียวหรือสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุชุดแรก เมื่อทำ การสับสวิตซ์จะทำให้แรงดันที่ตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เท่ากับแรงดันของแหล่งจ่าย การทำเช่นนี้ทำให้เกิดการพุ่งเกิน (overshoot) เทียบเท่ากับขนาดของแรงดันที่เปลี่ยนแปลง โดย แรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งที่เกิดขึ้นจะมีขนาดและความถี่สูง [2],[3] ซึ่งสามารถคำนวณหา สมการแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งได้ดังนี้



จากรูปที่ 2.1 สามารถหาสมการได้ดังนี้
iR + L
$$\frac{di}{dt}$$
 + $\frac{1}{C}$ ∫idt + V_c(0) = V_m sin(ω t + ϕ) (2.1)

และกำหนดให้สวิตซ์สับวงจรที่เวลา t =0 จากนั้นทำการแก้สมการ (2.1) จะได้ผลเฉลย ของกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุดังนี้

$$i_{c}(t) = V_{m} \sin(\omega t + \phi + \theta) + e^{-\alpha t} \begin{bmatrix} -\frac{V_{m}}{Z} \sin(\phi + \theta) \cos\beta t \\ +\frac{\sin \phi}{\beta} \begin{bmatrix} \frac{V_{m} \sin \phi - V_{c}(0)}{L} \\ -\frac{V_{m} \alpha}{Z} \sin(\phi + \theta) \\ -\frac{V_{m} \omega}{Z} \cos(\phi + \theta) \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$
(2.2)

เมื่อ

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)}$$

$$S = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + S^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{S}{R}\right)$$

จากนั้นหาแรงดันเกินสวิตชิ่งได้จากสมการ

$$V_{c} = \frac{1}{C} \int i dt$$
 (2.3)

จะได้ผลคำตอบของแรงดันที่ตัวเก็บประจุดังนี้

$$V_{c}(t) = -\frac{V_{m}}{C\omega Z} \cos(\omega t + \phi + \theta)$$

$$+ \frac{V_{m}e^{-\alpha t}}{CZ(\alpha^{2} + \beta^{2})} \begin{bmatrix} \sin(\phi + \theta)[\alpha\cos(\beta t) - \beta\sin(\beta t)] \\ + \frac{1}{\beta L} \begin{bmatrix} \beta\cos(\beta t) + \alpha\sin(\beta t)] \\ L\omega\cos(\phi + \theta) - Z\sin(\phi) \\ + \frac{V_{c}(0)Z}{V_{m}} + \alpha L\sin(\phi + \theta) \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$
(2.4)

หรือสามารถหาค่ากระแสพุ่งเข้าและความถี่โดยไม่พิจารณาค่าความต้านทานในระบบได้ จากมาตราฐาน ANSI/IEEE C37.012-1979 [4] และ IEC 60871-1 [5] ดังสมการ (2.5) ถึง (2.7)





จากรูปที่ 2.2 สามารถหากระแสพุ่งเข้าและความถี่ได้ดังนี้ จากมาตราฐาน ANSI/IEEE C37.012-1979

$$I_{max} = 1.41 \sqrt{I_{sc} \times I_{1}} \text{ with } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ kV}_{LL} \times 10^{3} \sqrt{\frac{\text{C}}{\text{L}_{T}}}$$
(2.5)

$$f = f_s \sqrt{\frac{I_{sc}}{I_1}} \quad \text{WFD} \quad \frac{10^6}{2\pi\sqrt{L_T \times C}}$$
(2.6)

เมื่อ

f

= ค่ายอดของกระแสพุ่งเข้า (A) I_{max}

= ความถี่ของกระแสพุ่งเข้า (Hz)

= ความถี่ของระบบ (Hz) f_s

$$L_{T} = L_{c} + L_{1} (\mu H)$$

$$L_T = L_S + L_1 (\mu H)$$

จากมาตราฐาน IEC 60871-1

$$I_{\rm S} \approx I_{\rm N} \sqrt{\frac{2S}{Q}}$$
 (2.7)

เมื่อ

Q = กำลังรีแอคทีฟของชุดตัวเก็บประจุ (Mvar)

2.3.1.2 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ Back-to-Back

การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบนี้เกิดเนื่องจากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุในขณะที่มี ชุดตัวเก็บประจุอื่นต่ออยู่ ซึ่งโดยปกติสถานีไฟฟ้ามักจะมีการแบ่งชุดตัวเก็บประจุออกเป็นหลาย ๆ ชุด เพื่อความสะดวกในการควบคุมแรงดันหรือแก้ไขตัวประกอบกำลัง(power factor) โดยการสับ ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 หรือ 3 อาจทำให้เกิดแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งมากกว่าในกรณีสับชุดตัว เก็บประจุแบบแยกเดี่ยว [2],[3] โดยสามารถคำนวณหาค่าแรงดันที่ตัวเก็บประจุ C₁ และ C₂ โดย ไม่พิจารณาค่าความต้านทานได้ดังนี้

รูปที่ 2.3 วงจรสมมูลชุดตัวเก็บประจุแบบ Back to Back

จากรูปที่ 2.3 สามารถหาสมการได้ดังนี้

$$L_{1} \frac{dI_{c1}}{dt} + V_{c1} = V_{m} \sin(\omega t + \phi)$$

$$L_{2} \frac{dI_{c2}}{dt} + V_{c2} = V_{c1}$$
(2.8)
(2.9)

ทำการแก้สมการ (2.8) และ (2.9) จะได้แรงดันที่ C1 และ C2 ดังนี้

$$V_{c1}(t) = A \left[D_{1} \cos(\omega_{d1}t) + D_{2} \sin(\omega_{d1}t) \right] + B \left[D_{3} \cos(\omega_{d2}t) + D_{4} \sin(\omega_{d2}t) \right] + EKV_{m} \sin(\omega t + \phi)$$

$$(2.10)$$

$$V_{c2}(t) = D_{1} \cos(\omega_{d1}t) + D_{2} \sin(\omega_{d1}t) + D_{3} \cos(\omega_{d2}t) + D_{4} \sin(\omega_{d2}t) + KV_{m} \sin(\omega_{t} + \phi)$$

$$(2.11)$$

เมื่อ

$$\omega_{1} = \frac{1}{\sqrt{L_{1}C_{1}}}$$

$$\omega_{2} = \frac{1}{\sqrt{L_{2}C_{2}}}$$

$$\omega_{d1} = \frac{\sqrt{(\omega_{1} + \omega_{2})^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}} + \sqrt{(\omega_{1} - \omega_{2})^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}}}{2}$$

$$\begin{split} \omega_{d2} &= \frac{\sqrt{\left(\omega_{1} + \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}} - \sqrt{\left(\omega_{1} - \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}}{2} \\ A &= 1 - \frac{\omega_{d1}^{2}}{\omega_{2}^{2}} \\ B &= 1 - \frac{\omega_{d2}^{2}}{\omega_{2}^{2}} \\ E &= 1 - \frac{\omega_{2}^{2}}{\omega_{2}^{2}} \\ K &= \frac{\omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2}}{\left[\left(\omega^{2} - \omega_{1}^{2}\right)\left(\omega^{2} - \omega_{2}^{2}\right) - \omega^{2}/L_{2}C_{1}\right]} \\ F &= \frac{1}{\left(\omega^{2}L_{1}C_{1} + 1\right)} \\ D_{1} &= \frac{V_{m}\sin\phi[F - (E - B)K]}{(A - B)} \\ D_{2} &= \frac{V_{m}\omega[F\sin\phi - (E - B)K\cos\phi]}{(A - B)\omega_{d1}} \\ D_{3} &= \frac{V_{m}\sin\phi[F - (E - A)K]}{(B - A)} \\ D_{4} &= \frac{V_{m}\omega[F\sin\phi - (E - A)K\cos\phi]}{(B - A)\omega_{d2}} \end{split}$$

จากนั้นสามารถหากระแสเกินสวิตซิ่งได้จากสมการ

$$i_{c} = C \frac{dv}{dt}$$
(2.12)

จะได้ผลคำตอบของกระแสเกินสวิตชิ่งดังนี้

$$i_{c1}(t) = C_1 A \omega_{d1} \Big[D_2 \cos(\omega_{d1} t) - D_1 \sin(\omega_{d1} t) \Big] + C_1 B \omega_{d2} \Big[D_4 \cos(\omega_{d2} t) - D_3 \sin(\omega_{d2} t) \Big] + C_1 E K \omega V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$(2.13)$$

$$i_{c2}(t) = C_2 \omega_{d1} \Big[D_2 \cos(\omega_{d1}t) - D_1 \sin(\omega_{d1}t) \Big] + C_2 \omega_{d2} \Big[D_4 \cos(\omega_{d2}t) - D_3 \sin(\omega_{d2}t) \Big] + C_2 K \omega V_m \cos(\omega t + \phi)$$
(2.14)

หรือสามารถหาค่ากระแสพุ่งเข้าและความถี่โดยไม่พิจารณาค่าความต้านทานในระบบได้ จากมาตราฐาน ANSI/IEEE C37.012-1979 และ IEC 60871-1 ดังสมการ (2.15) ถึง (2.17)

จากมาตรฐาน ANSI/IEEE C37.012-1979

$$I_{max} = 1917 \sqrt{\frac{kV_{LL}(l_{1})(l_{2})}{L_{eq}(l_{1}+l_{2})}}$$
(2.15)

$$f = 9.5 \sqrt{\frac{f_s \times kV_{LL}(l_1 + l_2)}{L_{eq} \times (l_1)(l_2)}}$$

เมื่อ

I_{max} = ค่ายอดของกระแสพุ่งเข้า (A)

f = ความถี่ของกระแสพุ่งเข้า (kHz)

f_s = ความถี่ของระบบ (Hz)

I₁ = กระแสของชุดตัวเก็บประจุที่จะสับสวิตช์ (A, rms)

I₂ = กระแสของชุดตัวเก็บประจุที่สับสวิตช์แล้ว (A, rms)

L_{eq} = ความเหนี่ยวนำรวมระหว่างชุดตัวเก็บประจุ (μH)

จากมาตรฐาน IEC 60871-1

$$I_{s} = \frac{U\sqrt{2}}{\sqrt{X_{c}X_{L}}} \quad \text{ime} \quad X_{c} = 3U^{2} \left(\frac{1}{Q_{1}} + \frac{1}{Q_{2}}\right) \cdot 10^{-6}$$
(2.17)

เมื่อ

I_s = ค่ายอดของกระแสพุ่งเข้า (A)

 $\mathsf{X}_{_{\mathrm{C}}}$ = อิมพีแดนซ์ของตัวเก็บประจุต่อเฟส (Ω)

 $\mathbf{X}_{_{\mathbf{I}}}$ = อิมพีแดนซ์ของความเหนี่ยวน้ำต่อเฟส ($\mathbf{\Omega}$)

Q₁ = กำลังรีแอคทีฟของชุดตัวเก็บประจุที่จะสับสวิตช์ (Mvar)

Q₂ = ผลรวมของกำลังรีแอคทีฟของชุดตัวเก็บประจุที่สับสวิตช์แล้ว (Mvar)

(2.16)



(a) แรงดันและกระแสของระบบ (b) แรงดันตกคร่อมชุดตัวเก็บประจุ (c) แรงดันตกคร่อมสวิตช์ รูปที่ 2.4 วงจรสมมูลการปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

โดยปกติแล้วการปลดสวิตซ์ของชุดตัวเก็บประจุจะทำในขณะที่กระแสเป็นศูนย์ ซึ่งในขณะ นั้นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเท่าแรงดันค่ายอด(V_p) และเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งรอบหลังการปลด สวิตช์ แรงดันของระบบจะเป็นค่ายอดแรงดันอีกครั้งแต่จะกลับขั้วกับแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุทำให้ เกิดแรงดันตกคร่อมที่หน้าสัมผัสของสวิตซ์มีค่าความต่างศักย์ถึง 2 V_p หากค่าแรงดันตกคร่อมหน้า สัมผัสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มีค่ามากกว่าค่าความคงทนได้ของไดอิเล็กตริก(dielectric strength) จะทำให้เกิดการเกิดเบรกดาวน์ในก๊าซที่อยู่ระหว่างหน้าสัมผัสและนำไปสู่การเกิดการอาร์ก เรียก ปรากฏการณ์นี้ว่า อาร์กซ้ำ เมื่อเกิดการอาร์กซ้ำจะเกิดการออสซิเลสระหว่างตัวเหนี่ยวนำกับตัว เก็บประจุ โดยมีสมการที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดังนี้ [6],[7]

$$V_{p}\sin(\omega t) = L\frac{di}{dt} + V_{c}$$
(2.18)

การออสซิเลสของวงจร LC ที่เกิดขึ้นจะเป็นความถี่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับความถี่ของ ระบบ ดังนั้นค่า V_p cos(ωt) สามารถคิดเป็นค่าคงที่ V_p ได้ จากนั้นทำการแก้สมการจะได้แรงดัน เกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเกิดอาร์กซ้ำดังนี้

$$V_{c}(t) = V_{p} - \left[V_{p} - V_{c}(0)\right] \cos\left(\omega_{0}t\right)$$
(2.19)

เมื่อ

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

จากนั้นสามารถหากระแสเกินสวิตซิ่งได้จากสมการ

$$i_{c} = C \frac{dv}{dt}$$
(2.20)

้ได้กระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากเกิดการอาร์กซ้ำดังนี้

$$i_{c}(t) = \left[V_{p} - V_{c}(0)\right] \sqrt{\frac{C}{L}} \sin(\omega_{0}t)$$
(2.21)

และสามารถหาความถี่ที่เกิดขึ้นได้ดังนี่

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \tag{2.22}$$

จากสมการ (2.19) พบว่าเมื่อเกิดการอาร์กซ้ำจะทำให้เกิดแรงดันเกินชั่วขณะมีค่าประมาณ 3 V_p (ที่จุด Aในรูปที่ 2.5)



หากสวิตช์สามารถตัดอาร์กเนื่องจากการเกิดอาร์ซ้ำเมื่อกระแสความถี่สูงผ่านศูนย์ได้ จะ เกิดแรงดันค้างที่ตัวเก็บประจุมีขนาด 3 V_p และเมื่อแรงดันของแหล่งจ่ายเพิ่มจนมีแรงดันขนาด 4 V_p ตกคร่อมสวิตซ์ ซึ่งมีโอกาสเกิดอาร์กซ้ำได้สูงมาก หากมีการเกิดอาร์กซ้ำอีกครั้ง ค่ากระแส เกินสวิตซิ่งที่เกิดจะมีค่าเป็นสองเท่าของการเกิดอาร์กซ้ำครั้งแรกเพราะแรงดันตกคร่อมสวิตซ์มีค่า 2 × 2V_p = 4V_p และแรงดันที่ตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนจาก +3 V_p เป็น –5 V_p และหากเหตุการณ์เช่น นี้เกิดซ้ำอีกก็จะทำให้แรงดันที่ตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้นเป็น +7 V_p, -9 V_p จนกระทั่งเกิดการวาบไฟตาม ผิวของตัวเก็บประจุหรือ ตัวเก็บประจุเสียหายเนื่องจากแรงดันหรือกระแสเกิน ซึ่งจะเรียกปรากฏ การณ์นี้ว่า อาร์กซ้ำหลายครั้ง (multiple restrike)

รูปที่ 2.6 แสดงรูปคลื่นแรงดันเนื่องจากการอาร์กซ้ำหลายครั้ง โดย R_s แทนการลำดับการ เกิดอาร์กซ้ำ และ C_s แทนลำดับการดับอาร์กซ้ำ



บทที่ 3

วิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจาก การสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

การสับและปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุทำให้เกิดแรงดันหรือกระแสเกินสวิตซิ่ง หากแรงดัน หรือกระแสดังกล่าวมีค่าสูงเมื่อเทียบกับภาวะปกติ อาจมีผลกระทบต่อระบบได้เช่น ทำให้อุปกรณ์ เสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนกำหนด

ในกรณีการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุเพียงชุดเดียวความรุนแรงของกระแสจะไม่มีผล กระทบต่อระบบมากนักเพราะขนาดของกระแสจะขึ้นกับค่าอิมพีแดนซ์ของระบบ แต่หากมีการสับ สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุในขณะที่มีชุดตัวเก็บประจุอื่นต่ออยู่ ค่ากระแสเกินสวิตชิ่งจะขึ้นกับค่า อิมพีแดนซ์ระหว่างตัวเก็บประจุแทน ซึ่งโดยปกติจะมีค่าสูงกว่าการสับชุดตัวเก็บประจุเพียงชุด เดียว

ส่วนกรณีการปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุจะเกิดปัญหาขึ้นหากมีการอาร์คซ้ำทำให้แรงดัน เกินสวิตชิ่งที่ตัวเก็บประจุอาจมีค่าสูงถึง 3 p.u. อาจทำให้ตัวเก็บประจุเกิดความเสียหายได้

จากปัญหาข้างต้นจึงมีการแก้ปัญหาโดยการหาวิธีการลดทอนหรือควบคุมเพื่อช่วยในการ จำกัดหรือลดผลของแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งให้มีผลกระทบต่อระบบน้อยที่สุด ในบทนี้จะ กล่าวถึงวิธีการควบคุมการเกิดแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับและปลดสวิตช์ชุดตัว เก็บประจุที่นิยมใช้โดยทั่วไป

3.1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ (Pre-insertion resistor)

ตัวต้านทานขนานกับเซอร์กิตเบรคเกอร์ [8]-[10] จะเป็นตัวช่วยลดแรงดันเกินสวิตซิ่งเนื่อง จากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุโดยตัวต้านทานจะแบ่งแรงดันระหว่างตัวต้านทาน,ระบบไฟฟ้า และชุดตัวเก็บประจุ ทั้งยังช่วยหน่วงทรานเซียนต์ที่เกิดขึ้นอีกด้วย



หลักการทำงานคือ สับสวิตซ์ S1 ก่อน แล้วสับสวิตซ์ S2 ตาม โดยทั่วไปแล้วทำการสับ สวิตซ์ S2 หลังสับสวิตซ์ S1 แล้ว ไม่เกิน 20 มิลลิวินาที ส่วนการปลดวงจรทำตรงกันข้ามกับสับ วงจรคือปลดสวิตซ์ S2 ก่อน

สำหรับขนาดของตัวต้านทานที่เหมาะสมเพื่อจำกัดแรงดันเกินสวิตชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด ควรมีค่าเท่ากับขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ

$$R_{\text{optimun}} \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$$
 (3.1)

เมื่อ

L = ความเหนี่ยวนำของแหล่งกำเนิด

C = ความจุไฟฟ้าของชุดตัวเก็บประจุ

สำหรับวิธีนี้มีผลดีในการลดแรงดันเกินสวิตซิ่งความถี่ต่ำ แต่วิธีการนี้ไม่เหมาะสมกับการ ใช้ในกรณี Back to Back เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากขนาดของกระแสพุ่งเข้าที่สูงนั้นเอง และไม่สามารถลดความถี่ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ข้อเสียอีกประการคือเมื่อค่าวงจรเปลี่ยนไปอาจ ต้องแก้ไขขนาดของตัวต้านทานด้วย

3.2 การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ (Pre-insertion inductor)



สำหรับการใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ [8]-[10] จะเป็นตัวช่วยลดแรงดันเกินสวิตชิ่งเนื่อง จากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ โดยมีหลักการใช้เหมือนการใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ แต่ระยะ เวลาในการสับ S1 โดยทั่วไปประมาณ 7-12 รอบก่อนสับ S2 โดยตัวเหนี่ยวนำจะลดค่าแรงดัน เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขณะสับสวิตซ์ S1 ซึ่งวิธีนี้จะได้ประสิทธิภาพเมื่อค่าความเหนี่ยวนำที่นำมาใช้มี ค่าสูงกว่าค่าความเหนี่ยวนำของระบบไฟฟ้า โดยปรกติค่าความเหนี่ยวนำที่เหมาะสมจะมีค่า ประมาณสองเท่าของค่าความเหนี่ยวนำของระบบ ซึ่งค่าความเหนี่ยวนำที่เหมาะสมจะมีค่า ขนาดกระแสลัดวงจร ดังนั้นหากขนาดกระแสลัดวงจรมีค่าต่ำก็ต้องใช้ความเหนี่ยวนำที่นำมาติดตั้งอาจมี ขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการติดตั้งได้ จึงมีการแก้ไขโดยเพิ่มความต้านทานเข้ามาในชุดตัว เหนี่ยวนำ ทำให้สามารถลดขนาดของตัวเหนี่ยวนำลงได้

การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ช่วยในการจำกัด ^{dv}/_{dt} ของแรงดันเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น ซึ่ง เหมาะสมกับการใช้ในกรณี Back to Back เพราะสามารถจำกัดทั้งขนาดและความถี่ของกระแส พุ่งเข้าได้ แต่มีข้อเสียคือแรงดันเกินที่ปลายสายส่งที่ระยะทางไกล อาจมีค่าสูงกว่าเมื่อไม่มีการ ควบคุมแรงดันหรือกระแสเกินสวิตซิ่งได้

3.3 การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุ

การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุ [8],[11],[12] มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กระแสเกินสวิตซิ่งที่ไหลเข้าอย่างรุนแรงเนื่องจากการสับชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back และ กระแสเกินที่ไหลออกอย่างรุนแรงเนื่องจากความผิดพร่อง(fault)บนบัสหรือจุดที่ใกล้กับตัวเก็บ ประจุ สำหรับขนาดอิมพีแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดแรงดันเกินสวิตซิ่งต่ำที่สุดควรมีขนาด ประมาณ 6 % หรือ 7 %ของขนาดอิมพีแดนซ์ของชุดตัวเก็บประจุ

การใช้วิธีดังกล่าวต้องสูญเสียกำลังรีแอกทีฟจากชุดตัวเก็บประจุส่วนหนึ่งไปเนื่องจากการ ต่อตัวเหนี่ยวนำนี้

3.4 การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ (Synchronous Closing Control)

เนื่องจากขนาดของแรงดันเกินสวิตซิ่งที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับมุมของแรงดันที่ทำการสับ สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุด้วย โดยที่ขนาดของแรงดันเกินสวิตซิ่งจะมีขนาดสูงเมื่อทำการสับสวิตช์ขณะ แรงดันที่บัสมีค่าใกล้ยอดคลื่น และจะมีขนาดต่ำเมื่อแรงดันที่บัสมีค่าใกล้ศูนย์ [8]-[11]

จากผลที่ได้นี้นำมาใช้เป็นหลักการทำงานของชุดควบคุมการปิดสวิตช์ขณะแรงดันมีค่า เป็นศูนย์ เพื่อลดแรงดันเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ นั้นคือควบคุมให้สับ สวิตช์ (หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์) ในแต่ละเฟสแยกเป็นอิสระต่อกัน โดยเวลาที่ใช้ในการสับสวิตช์ทั้ง หมดคือ เวลาที่อุปกรณ์ทำงาน (y) บวกกับตัวแปรของเวลาในแต่ละ เฟส (a, b และ c) นอกจากนี้ เวลาการสับสวิตช์จะขึ้นกับลักษณะการต่อของชุดตัวเก็บประจุด้วยดังนี้





รูปที่ 3.3 การต่อชุดตัวเก็บประจุ

3.4.1 ต่อแบบวายต่อลงดิน

ให้เฟส A เป็นเฟสอ้างอิง และเลือกเวลาการสับสวิตซ์แต่ละเฟสเมื่อแรงดันมีค่าเป็นศูนย์ การกำหนดลำดับของเวลาของระบบไฟฟ้าสามเฟส จากกระแสจะมีค่าเป็นศูนย์ที่ทุกๆ มุม 60 องศา หรือ ทุกๆ 3.33 มิลลิวินาที ฉะนั้นเวลาที่ใช้ในการสับสวิตช์จะเป็นดังนี้

เฟส A	:	$a + y_1 = n \times 10$	ms.
เฟส B	:	b + y ₂ = n × 10 - 3.33 หรือ +3.33	ms.
เฟส C	:	c + y ₃ = n × 10 - 3.33 หรือ +6.66	ms.

เมื่อ n คือ จำนวนเต็มที่ n × 10 > y y₁,y₂,y₃ คือ เวลาที่ใช้ในการสับสวิตช์ของอุปกรณ์ในแต่ละเฟส a, b, c คือ เวลาหน่วงของแต่ละเฟส

3.4.2 ต่อแบบวายไม่ต่อลงดิน

ในกรณีนี้ให้เฟส A เป็นเฟสอ้างอิง แต่จะสับสวิตช์ของเฟส A และ B พร้อมกันเมื่อแรงดัน ระหว่างเฟส A และ B มีค่าเป็นศูนย์ จากนั้นสับสวิตช์ของเฟส C เมื่อเวลาผ่านไป 5 ms (แรงดันที่ เฟส C มีค่าเป็นศูนย์)

ที่ต้องสับสวิตช์ของเฟส A และ B พร้อมกันเพื่อป้องกันกระแสไหลในวงรอบปิด เมื่อ พิจารณารูปที่ 3.3 (ข) พบว่าถ้าสับสวิตช์ที่เฟส A เพียงเฟสเดียว และปิดในขณะที่แรงดันของ เฟส A มีค่าเป็นศูนย์ เฟส A จะเสมือนว่าเป็นดิน เพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดกระแสไหลจากเฟสที่เหลืออีก 2 เฟส ไปเฟส A ได้

 $i \forall a A :$ $a + y_1 = (n \times 10) - 3.33 - 5$ ms. $i \forall a B :$ $b + y_2 = (n \times 10) - 3.33 - 5$ ms. $i \forall a C :$ $c + y_3 = (n \times 10) - 3.33$ ms.



รูปที่ 3.4 ภาพแสดงเวลาในการสับสวิตช์

ข้อดีของวิธีการนี้คือ ชุดควบคุมนี้ไม่ขึ้นกับพารามิเตอร์ของระบบ ดังนั้นไม่ว่าจะสับชุดตัว เก็บประจุในกรณีของสับชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว หรือแบบ Back to Back วิธีการนี้ยัง สามารถใช้งานได้

ข้อเสียวิธีนี้คือ ต้องรักษาเวลาในการสับสวิตช์ดังที่กล่าวไปแล้วให้ได้ เพราะเวลาที่ผิด พลาดไปเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่มีขนาดสูงได้

3.5 การใช้กับดักฟ้าผ่าแบบ MOV

การใช้กับดักฟ้าผ่าแบบ MOV (metal oxide varistor) สามารถใช้ป้องกันตัวเก็บประจุจาก แรงดันเกินฟ้าผ่าและใช้ป้องกันลดแรงดันเกินสวิตซิ่งจากการเกิดอาร์กซ้ำขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บ ประจุ [13]-[16] ซึ่งมีข้อดีหลายประการดังนี้

- ป้องกันตัวเก็บประจุเสียหายเนื่องจากการเกิดอาร์กซ้ำในสวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์
- ลดโอกาสในการเกิดอาร์กซ้ำหลายครั้ง
- ยืดอายุการใช้งานของตัวเก็บประจุโดยกำจัดแรงดันเกิน
- เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันภาวะรีโซแนนซ์ที่เกิดอย่างไม่คาดคิดซึ่งทำให้ตัวเก็บประจุเสียหาย
- จำกัดทรานเซียนต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสวิตชิ่งตัวเก็บประจุซึ่งจะส่งผ่านไปยังระบบและเกิด การรบกวนอุปกรณ์ที่มีความไวสูง
- ใช้ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับชุดตัวเก็บประจุที่ต่อกับสายส่ง
การเลือกกับดักฟ้าผ่าสำหรับป้องกันชุดตัวเก็บประจุต้องพิจารณาค่าดังต่อไปนี้

3.5.1 แรงดันใช้งานต่อเนื่อง (Continuous operating voltage, ${\rm U_c}$)

แรงดันใช้งานต่อเนื่องคือแรงดันต่อเนื่องสูงสุดที่ปรากฏระหว่างขั้วของกับดักฟ้าผ่าโดยการ เลือกค่า U_c ต้องพิจารณาถึงค่าแรงดันใช้งานสูงสุดในภาวะปรกติของตัวเก็บประจุซึ่งอนุญาตให้มี แรงดันเกินได้ 5%-10% และต้องพิจารณาลักษณะการต่อกับดักฟ้าผ่าด้วย เช่น กับดักฟ้าผ่าต่อ ระหว่างเฟส-กราวด์หรือระหว่างเฟส-นิวทรอล ค่า U_c จะต้องใช้ค่าแรงดันเฟส เป็นต้น

3.5.2 แรงดันพิกัด (Rated voltage, U_r)

แรงดันพิกัดเป็นการวัดความสามารถในการรับแรงดันเกินของกับดักฟ้าผ่า ซึ่งมีหลักการ คำนวณจากแรงดันเกินชั่วขณะ(TOV) โดยแบ่งเป็นกรณีได้ดังนี้

3.5.2.1 กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-กราวด์

<u>กรณีที่1</u> ทราบขนาดและระยะเวลาของ TOV

- ระยะเวลา ≤ 1 s เลือก U_r ≥ 0.88×TOV

- ระยะเวลา ≤ 10 s เลือก U_r ≥ 0.93×TOV
- ระยะเวลา ≤ 100 s เลือก U_r ≥ TOV
- ระยะเวลา < 2 h เลือก U_r ≥ 1.1×TOV
- ระยะเวลา ≥ 2 h พิจารณาค่า TOV เป็นค่าต่อเนื่องและเลือก ∪_c เท่ากับค่า TOV

<u>กรณีที่2</u> ไม่ทราบค่า TOV แบ่งได้เป็น

ระบบต่อลงกราวด์ สมมุติค่า TOV =1.55 Us

- ระยะเวลา ≤ 1 s เลือก U_r ≥ 0.88×TOV

- ระบบไม่ต่อลงกราวด์ สมมุติค่า TOV=1.73 Us
 - ระยะเวลา ≤ 10 s เลือก U_r ≥ 0.93×TOV
 - ระยะเวลา ≤ 100 s เลือก U_r ≥ TOV
 - ระยะเวลา < 2 h เลือก U_r ≥ 1.1×TOV
 - ระยะเวลา ≥ 2 h พิจารณาค่า TOV เป็นค่าต่อเนื่องและเลือก U_c เท่ากับค่าแรงดันระบบ ที่ใช้งาน

เมื่อ Us เป็นค่าแรงดันเฟส

3.5.2.2 กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอล

ในกรณีนี้คำนวณแบบเดียวกับกรณีต่อระหว่างเฟส-กราวด์ แต่สามารถลดระดับแรงดัน พิกัดลงมาได้เพราะเมื่อเกิดการลัดวงจรลงดิน กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลจะรับค่า TOV น้อยกว่ากับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-กราวด์ แต่หากทำการเลือกแรงดันพิกัดของกับดักฟ้าผ่าต่อ ระหว่างเฟส-นิวทรอลเท่ากับแบบเฟส-กราวด์ ก็เพื่อให้มีส่วนเผื่อ(safety margin)

3.5.2.3 กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์

ในกรณีนี้คำนวณแบบเดียวกับกรณีต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลเพียงแต่กับดักฟ้าผ่าที่ต่อ ระหว่างนิวทรอล-กราวด์นั้นสามารถเลือกใช้แรงดันพิกัดต่ำๆแทนที่จะใช้กับดักฟ้าผ่าที่มีแรงดัน พิกัดเท่ากับกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างเฟส-นิวทรอล

3.5.3 ความสามารถในการรับพลังงาน (Energy Absorbtion)

ความสามารถในการรับพลังงานของกับดักฟ้าผ่าจะขึ้นกับขนาดของกระแสดีสชาร์จ ซึ่ง สามารถแบ่งระดับพลังงานตามมาตราฐาน IEC 60099-4 โดยการเกิดอาร์กซ้ำจะมีค่ากระแสที่เกิด ขึ้นสูง ดังนั้นความสามารถในการรับพลังงานของกับดักฟ้าผ่าจึงเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ต้องนำมา พิจารณาเพื่อให้ได้กับดักฟ้าผ่าที่เหมาะสมกับการป้องกันชุดตัวเก็บประจุ โดยพลังงานที่กับดักฟ้า ผ่าจะได้รับหาได้จากสมการ

$$E_{c} = \left(V_{o}^{2} - V_{a}^{2}\right)\frac{C}{2}$$

โดย

E คือพลังงานที่กับดักฟ้าผ่าได้รับ

C คือความเก็บประจุของชุดตัวเก็บประจุ

V คือแรงดันก่อนที่กับดักฟ้าผ่าจะทำงาน

V คือแรงดันหลังที่กับดักฟ้าผ่าทำงาน

(3.2)

บทที่ 4

อุปกรณ์และวิธีการตรวจวัดรูปคลื่นที่สถานีไฟฟ้าย่อย

บทนี้นำเสนออุปกรณ์และวิธีการตรวจวัดรูปคลื่นที่สถานีไฟฟ้าที่ใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับ กรณีศึกษานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการใช้สถานที่เพื่อทำการตรวจวัด รูปคลื่น รวมทั้งการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการจำลอง โดย สถานีไฟฟ้าย่อยที่เป็นกรณีศึกษามีแบบผังของระบบดังนี้



การตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลจะวัดแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุชุด No.1 ซึ่งประกอบด้วยชุด ตัวเก็บประจุจำนวน 3 ชุด ขนาดแต่ละชุด 2.4 Mvar โดยวัดแรงดันที่เฟส A ของชุดตัวเก็บประจุชุด ที่ 1 สำหรับหม้อแปลงจะใช้งานด้านหม้อแปลง KT1A ส่วนหม้อแปลง KT2A และชุดตัวเก็บประจุ ชุด No. 2 จะปลดออก ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจวัดจะนำไปเปรียบเทียบกับผลของการจำลองด้วย โปรแกรม EMTP/ATPต่อไป

4.1 การตรวจวัดรูปคลื่นแรงดัน

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีความสามารถในการจับรูปคลื่นแรงดันได้โดยที่ไม่ทำให้รูป คลื่นที่ได้มีความผิดเพี้ยน จึงมีการทดสอบอุปกรณ์ในการตรวจวัดก่อนที่จะนำไปใช้งาน โดยป้อน แรงดันสวิตชิ่ง 250/2500 µs เพื่อตรวจรูปคลื่นที่ได้ ในที่นี้มีอุปกรณ์ 2 ชนิดที่นำมาทดสอบได้แก่ หม้อแปลงแรงดัน(voltage transformer) และโวลเตจดิไวเดอร์ (voltage divider)พร้อมตัวลดทอน ้สัญญาณ (attenuator) หลังการทดสอบพบว่าโวลเตจดิไวเดอร์สามารถตรวจวัดแรงดันสวิตซิ่ง 250/ 2500 μs ได้ดีกว่าหม้อแปลงแรงดัน ดังนั้นจึงใช้โวลเตจดิไวเดอร์เป็นอุปกรณ์ในการตรวจวัด รูปคลื่น โดยทำการตรวจวัดที่เฟส A ทั้งหมด 4 ตำแหน่งคือที่จุด P1 ถึง P4 สำหรับตำแหน่งที่ติดตั้ง โวลเตจดิไวเดอร์ดังรูปที่ 4.2 และรูปในการติดตั้งจะแสดงดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.2 ตำแหน่งติดตั้งโวลเตจดิไวเดอร์

V1 คือโวลเตจดิไวเดอร์ที่ตรวจวัดแรงดันระหว่างบัสกับกราวด์ที่จุด P1 เมื่อ V2 คือโวลเตจดิไวเดอร์ที่ตรวจวัดแรงดันระหว่างหน้าตัวเหนี่ยวน้ำกับกราวด์ที่จุด P2 V3 คือโวลเตจดิไวเดอร์ที่ตรวจวัดแรงดันระหว่างหน้าชุดตัวเก็บประจุกับกราวด์ที่จุด P3 V4 คือโวลเตจดิไวเดอร์ที่ตรวจวัดแรงดันระหว่างนิวทรอลกับกราวด์ที่จุด P4



รูปที่ 4.3 การติดตั้งโวลเตจดิไวเดอร์

สำหรับส่วนการแสดงผลและจัดเก็บข้อมูลรูปคลื่นแรงดันนั้นจะใช้ออสซิโลสโคปเป็น อุปกรณ์ในการแสดงผลรูปคลื่นแรงดันที่ตำแหน่งต่าง ๆ โดยรับสัญญาณผ่านโวลเตจดิไวเดอร์และ ตัวลดทอนสัญญาณและส่งข้อมูลรูปคลื่นแรงดันจากออสซิโลสโคปไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บ ข้อมูลดังรูปที่ 4.4 และแสดงรูปอุปกรณ์ดังรูปที่ 4.5





รูปที่ 4.5 อุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกรูปคลื่น

1) ตัวลดทอน 2) ออสซิโลสโคป 3) โน้ตบุค

สำหรับรูปคลื่นกระแสจะนำรูปคลื่นแรงดันแทนในสมการ

$$I_{\rm C} = C \frac{dV}{dt} \tag{4.1}$$

เนื่องจากมีคลื่นรบกวนเข้ามาขณะตรวจวัดจึงต้องกรองคลื่นรบกวนออกไปเสียก่อนโดยใช้ ตัวกรองแบบดิจิตอล (digital filter)แล้วจึงแทนค่าแรงดันในสมการ (4.1)

4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดรูปคลื่นแรงดัน

จะระบุถึงพิกัดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดรูปคลื่นจากหัวข้อ 4.1 ซึ่งมีดังนี้

- 1. โวลเตจดิไวเดอร์ (V1) พิกัด 100 kV พร้อมตัวลดทอนสัญญาณ มีอัตราส่วนแรงดันรวม 1 : 4807
- 2. โวลเตจดิไวเดอร์ (V2) พิกัด 200 kV พร้อมตัวลดทอนสัญญาณ มีอัตราส่วนแรงดันรวม 1 : 6218.6
- โวลเตจดิไวเดอร์ (V3) พิกัด 200 kV พร้อมตัวลดทอนสัญญาณ มีอัตราส่วนแรงดันรวม 1 : 5944.5
- 4. โวลเตจดิไวเดอร์ (V4) พิกัด 100 kV พร้อมตัวลดทอนสัญญาณ มีอัตราส่วนแรงดันรวม 1 : 4260.2
- 5. ออสซิโลสโคป มีอัตราชักตัวอย่าง (sampling rate) 1 GS/s
- 6. คอมพิวเตอร์

บทที่ 5

กรณีศึกษาการสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุในสถานีไฟฟ้าย่อย

บทนี้นำเสนอแบบจำลองของสถานีไฟฟ้าย่อยและผลการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการ ตรวจวัดกับผลที่ได้จากการจำลอง พร้อมทั้งศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ในระบบเมื่อสับและ ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ โดยเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้น

5.1 ข้อมูลและแบบจำลองของสถานีไฟฟ้าย่อย

จะนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจำลองของสถานีไฟฟ้าย่อยที่ใช้ในโปรแกรม EMTP/ ATP ซึ่ง จะได้แบบจำลองดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 แบบจำลองสถานีไฟฟ้า

ซึ่งวิธีการคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆ ในแบบจำลองสถานีไฟฟ้ามีดังนี้

5.1.1 วงจรป้อนของระบบ



ส่วนวงจรป้อน (feeding network)ของระบบแสดงดังรูปที่ 5.2 และส่วนที่ 1 ของรูปที่ 5.1 โดยวงจรป้อนนี้เป็นส่วนที่ป้อนพลังงานเข้ามายังสถานีไฟฟ้า ในส่วนนี้สามารถสร้างแบบจำลอง แทนวงจรป้อนได้ 3 ประเภทดังนี้

5.1.1.1 อิมพีแดนซ์ลัดวงจร (Short circuit impedance)

เป็นแบบจำลองที่แทนวงจรป้อนด้วยค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจรต่อขนานกับค่าอิมพีแดนซ์เสิร์จ ของสายส่ง ในกรณีศึกษานี้ใช้ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจรที่ระดับแรงดัน 115 kV หน้าหม้อแปลงลด แรงดัน 115 kV / 22 kV ซึ่งมีค่าดังนี้

$$Z_{1,2} = 0.021 + j0.06938$$
 p.u.
 $Z_{2} = 0.00381 + j0.04911$ p.u.

เมื่อคำนวณมาอยู่ในค่าจริง โดย Z_{_{base}} = 115^2/100 =132.25 Ω จะได้

R_{1,2} = 2.7773 Ω และ L_{1,2} = 29.1953 mH

$$R_{_0}$$
 = 0.8504 Ω และ $L_{_0}$ = 26.8388 mH

ส่วนอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่งจากรูปที่ 5.2 พบว่ามีจำนวนสายส่ง 8 สายต่อขนานกันเข้ามายัง กรณีศึกษา มีค่าเป็น 46.056 Ω

5.1.1.2 สายส่งแบบพารามิเตอร์คงที่ (Constant parameter line)

เป็นแบบจำลองที่แทนวงจรป้อนด้วยสายส่งแบบพารามิเตอร์คงที่ประกอบไปด้วย ค่า ความต้านทานสูญเสีย R = R(f_t) = เสิร์จอิมพีแดนซ์ $Z_0 = Z_0(f_t) = \sqrt{\frac{L}{C}}$ และ ความเร็วเสิร์จ v = $v(f_t) = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ โดย f_t คือ ความถี่หลักที่สภาวะทรานเซียนต์ สำหรับส่วนถัดไปซึ่งนอกเหนือส่วนที่ พิจารณาจะแทนด้วยค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร โดยข้อมูลจะแสดงอยู่ในภาคผนวก ข. จากนั้นนำมา คำนวณให้อยู่ในค่าจริง ดังตารางที่ 5.1 และ 5.2 และแสดงแบบจำลองดังรูปที่ 5.3

BusName	Bus (kV)	$R_1(\Omega)$	L ₁ (mH)	$R_{_{0}}\left(\Omega ight)$	L ₀ (mH)
HHO	230	0	292.8958	0	139.4710
PMN	115	0	45.2995	0	35.0655
SS	115	11.4489	82.8056	0.9760	73.7836
UB1	115	21.7221	142.5639	1.0144	76.8723
SRD	115	6.3824	156.2021	0.0926	9.1230
AN	<mark>115</mark>	6.8730	50.3281	1.9811	56.0973

ตารางที่ 5.1 ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร

ตารางที่ 5.2 พารามิเตอร์ของสายส่ง

DuoNomo	R ₁	L ₁	R_0	L ₀	C ₁	C ₀	Length
Busivarile	(Ω/km)	(mH/km)	(Ω/km)	(mH/km)	(µF/km)	(µF/km)	(km)
HHO-UB2	0.0519	1.2521	0.2880	3.9649	0.0088	0.0070	230.236
PMN- UB2	0.1341	1.2162	0.3434	4.3980	0.0091	0.0057	71
SS-UB2	0.1341	1.2162	0.3434	4.3980	0.0091	0.0057	60.2
UB1-UB2	0.1341	1.2162	0.3434	4.3980	0.0091	0.0057	29.9
UB1-SRD	0.3439	1.2854	0.5563	4.5407	0.0086	0.0054	63.31
UB1-AN	0.3411	1.3174	0.6017	4.0992	0.0082	0.0045	65



5.1.1.3 สายส่งแบบพารามิเตอร์ขึ้นกับความถี่ (Frequency-dependent parameter line)

เป็นแบบจำลองที่แทนวงจรป้อนด้วยสายส่งแบบพารามิเตอร์ขึ้นกับความถี่ โดยพิจารณา ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นฟังก์ชันความถี่ ซึ่งในการใช้งานจะป้อนข้อมูลของการจัดวางสายส่ง สำหรับส่วนถัดไปซึ่งนอกเหนือส่วนที่พิจารณาจะแทนด้วยค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร โดยแสดงแบบ จำลองดังรูปที่ 5.4 (สำหรับข้อมูลจะแสดงในภาคผนวก ข.)



รูปที่ 5.4 วงจรป้อนแทนด้วยสายส่งแบบพารามิเตอร์ขึ้นกับความถี่

5.1.2 หม้อแปลง

แสดงในส่วนที่ 2 ของรูปที่ 5.1 ซึ่งหม้อแปลงที่ใช้เป็นหม้อแปลงลดแรงดัน 115 kV/ 22 kV/ 11 kV ต่อแบบ Yy0(d1) ขนาด 50 MVA มีค่า %Z เท่ากับ 12.28% เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีไม่เพียง พอและด้านตติยภูมิใช้เป็นตัวช่วยจำกัดกระแสผิดพร่องเมื่อเวลาเกิดการผิดพร่องมิได้นำไปใช้งาน จึงจำลองให้เป็นหม้อแปลงชนิด 2 ขดลวด และสมมุติ $rac{X}{R}=10$ [20] ดังนั้นคำนวณค่าพารา มิเตอร์ต่างๆได้ดังนี้

$$R = \sqrt{\frac{\left(\frac{\%Z}{100}\right)^2}{1 + \left(\frac{X}{R}\right)^2}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{12.28}{100}\right)^2}{101}} = 0.012219 \text{ p.u.}$$
$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{0.1228^2 - 0.012219^2} = 0.12219 \text{ p.u.}$$

จาก [17] แนะนำให้แบ่งค่าความต้านทานและความเหนี่ยวน้ำที่ได้ข้างต้น ออกเป็นสอง ส่วนเท่าๆกัน เพื่อแทนค่าความต้านทานและความเหนี่ยวนำของขดลวดด้านแรงแรงสูงและด้าน แรงต่ำดังรูปที่ 5.5



ฉะนั้นได้ค่าทางด้านแรงสูงดังนี้

เมือ
$$Z_{\text{base}} = 115^2/50 = 264.5 \Omega$$

 $R_{\text{HV}} = \frac{0.012219}{2} \times 264.5 = 1.616 \Omega$
 $L_{\text{HV}} = \frac{0.12219}{2} \times 264.5 \times 100\pi = 51.4182 \text{ mH}$
 $V_{\text{HV}} = 115 \text{ kV} / \sqrt{3} = 66.395 \text{ kV}$

และได้ค่าทางด้านแรงต่ำดังนี้

ເລື້ອ
$$Z_{\text{base}} = 22^2/50 = 9.68 \,\Omega$$

 $R_{\text{LV}} = \frac{0.012219}{2} \times 9.68 = 0.0591 \Omega$
 $L_{\text{LV}} = \frac{0.12219}{2} \times 9.68 \times 100 \pi = 1.8818 \,\text{mH}$
 $V_{\text{LV}} = 22 \,\text{kV} / \sqrt{3} = 12.701 \,\text{kV}$

5.1.3 ชุดตัวเก็บประจุ

แสดงในส่วนที่ 3 ของรูปที่ 5.1 ซึ่งเป็นชุดตัวเก็บประจุระดับแรงดัน 12.7 kV ขนาด 2.4 Mvar จำนวน 3 ชุด ต่อแบบดับเบิ้ลวายไม่ต่อลงดิน (double unground-wye)เป็นการต่อตัวเก็บ ประจุย่อยต่อแบบวายไม่ต่อลงดิน 2 ชุดขนานกันเพื่อสะดวกในการตรวจจับความผิดพร่องดังรูปที่ 5.6 และมีกำลังสูญเสีย (Power loss) 0.2 W/kvar คำนวณหาค่าความเก็บประจุได้ดังนี้

$$C = \frac{M var_{1\phi}}{2\pi f \left(kV_{LL} / \sqrt{3} \right)^2} = \frac{2.4/3}{2\pi \times 50 \times \left(\frac{22}{\sqrt{3}} \right)^2} = 15.783 \,\mu F$$

ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุคำนวณได้จาก

$$R_{phase} = \frac{P_{loss_{phase}}}{I_{FL_{\phi}}^{2}} = \frac{800 \text{kVar} \times 0.2}{\left(\frac{\text{kvar}_{bank}}{\sqrt{\sqrt{3} \times \text{kV}_{LL}}}\right)^{2}} = \frac{160}{63^{2}} = 0.0403 \,\Omega$$



รูปที่ 5.6 การต่อตัวเก็บประจุแบบดับเบิ้ลวายไม่ต่อลงดิน

เนื่องจากการไปตรวจวัดรูปคลื่นได้มีการวัดค่าความเก็บประจุดังนั้นจึงใช้ค่าความเก็บ ประจุที่ได้จากการวัดเป็นค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการจำลอง มีดังนี้

	เฟส A	เฟส B	เฟล C
ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1	16.115 μF	16.32 μF	15.94 μF
ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2	16.04 µF	15.99 μF	16.10 μF
ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3	15.94 μF	16.01 μF	16.13 μF

5.1.4 ตัวเหนี่ยวนำ

แสดงในส่วนที่ 4 ของรูปที่ 5.1 ซึ่งเป็นค่าความเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุใน สถานีไฟฟ้าย่อยเท่ากับ 0.1 mH เนื่องจากข้อมูลมีไม่เพียงพอ จึงสมมุติ X/R = 15 [20] ฉะนั้น ได้ R = <u>0.1mH × 2π × 50</u>/15 = 0.0021Ω

5.1.5 โหลดของสถานีไฟฟ้า

แสดงในส่วนที่ 5 ของรูปที่ 5.1 ซึ่งเป็นขนาดของโหลดได้จากบันทึกของการไฟฟ้าในวันที่ ไปตรวจวัดรูปคลื่น โดยจำลองโหลดด้วยพารามิเตอร์ความต้านทานกับความเหนี่ยวนำขนานกัน แต่ละชนิดจัดวางแบบวายต่อลงดิน (grounded – wye) เช่นในการตรวจวัดได้ค่าโหลด 13.5 MW และ 5.2 Mvar

ค่าความต้านทานหาได้จาก $\frac{V^2}{P}$ นั้นคือ $\frac{22^2}{13.5} = 35.85 \,\Omega$ ในทำนองเดียวกันจะได้ค่า ความเหนี่ยวนำจาก $\frac{V^2}{Q}$ จะได้ $\frac{22^2}{5.2} = 93.07 \,\Omega$ หรือ 296.27 mH

ชุดตัวเก็บประจุ	MW	Mvar	R (Ω)	L (mH)
สับสวิตช์ชุดที่ 1	13. <mark>5</mark>	5.2	35.85	296.27
ปลดสวิตช์ชุดที่ 1	13.2	4.3	36.67	358.28
สับสวิตช์ชุดที่ 3	13.1	3.7	36.95	416.38
ปลดสวิตช์ชุดที่ 3 🐂	13	2.7	37.23	570.60

ตารางที่ 5.3 ค่าพารามิเตอร์โหลดที่ใช้ในการจำลอง

ในส่วนของโหลดนั้นถือเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญเพราะเป็นตัวช่วยในการลดทอน แรงดันเกินสวิตชิ่งจากการสับและปลดชุดตัวเก็บประจุ หากจำลองโดยละทิ้งโหลดก็จะทำให้แรง ดันเกินที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากการตรวจวัด

5.2 การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจวัดกับการจำลองด้วยโปรแกรม EMTP/ATP

เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการจำลองด้วยโปรแกรม EMTP/ATP เทียบกับผล ที่ได้จากการตรวจวัด และในการจำลองจะใช้แบบจำลอง 3 แบบนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งแบบจำลอง ทั้งสามจะมีแบบจำลองส่วนที่แทนวงจรป้อนที่แตกต่างกัน สำหรับแบบจำลองส่วนอื่นจะใช้เหมือน กัน เพื่อดูผลของคลื่นจร (travelling wave) ในสายส่งที่เกิดจากการสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บ ประจุ โดย - แบบจำลองที่ 1 (model 1) คือ แบบจำลองที่แทนวงจรป้อนด้วยค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร

- แบบจำลองที่ 2 (model 2) คือ แบบจำลองที่แทนวงจรป้อนด้วยสายส่งแบบพารามิเตอร์ คงที่

- แบบจำลองที่ 3 (model 3) คือแบบจำลองที่แทนวงจรป้อนด้วยสายส่งแบบพารามิเตอร์ ขึ้นกับความถี่

การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1

จะสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 เพียงชุดเดียว เป็นกรณีการสับชุดตัวเก็บประจุแบบ แยกเดี่ยว โดยจะเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการตรวจวัดกับผลการจำลอง ซึ่งการสับสวิตช์นี้จะไม่ แสดงรูปคลื่นที่จุดนิวทรอล (P4) เนื่องจากมีค่าต่ำ สำหรับรูปคลื่นแรงดันและกระแสจากการตรวจ วัดและการจำลองทั้งสามแบบจำลองจะแสดงดังรูปที่ 5.7 ถึง 5.10

ตารางที่ 5.4 เปรียบเทียบแรงดันเกินสวิตชิ่ง (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)

Deint	Peak Voltage (V)									
FUIIL	Measure	Model 1	% error	Model 2	% error	Model 3	% error			
P1	26288.28	24902.18	-5.27	26037.94	-0.95	26061.32	-0.86			
P2	26234.72	24902.18	-5.08	26037.94	- 0.75	26061.32	-0.66			
P34	26359.51	25094.46	-4.80	26250.37	-0.41	26273.94	-0.32			

ตารางที่ 5.5 เปรียบเทียบกระแสเกินสวิตชิ่ง (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)

Point		Peak Current (A)									
FUIII	Measure	Model 1	% error	Model 2	2 % error Model 3	% error					
C34	1692.36	881.23	-47.93	923.38	-45.44	924.09	-45.40				

หมายเหตุ P1 คือ แรงดันระหว่างบัสเทียบกับกราวด์

P2 คือ แรงดันระหว่างหน้าตัวเหนี่ยวน้ำกับกราวด์

P34 คือ แรงดันตกคร่อมชุดตัวเก็บประจุ

C34 คือ กระแสไหลผ่านชุดตัวเก็บประจุ





การปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1

สำหรับการปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 จะไม่แสดงรูปคลื่นจุด P1 เพราะในการปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุนั้น แรงดันที่ P1 ซึ่งเป็นแรงดันที่บัสไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง สำหรับรูปคลื่น แรงดันและกระแสจากการตรวจวัดและการจำลองทั้งสามแบบจำลองแสดงดังรูปที่ 5.11 ถึง 5.13

Deint	Peak Voltage (V)									
FUIII	Measure	Model 1	% error	Model 2	% error	Model 3	% error			
P2	27400.7	26780.7	-2.26	27920.8	1.90	27949.9	2.00			
P34	19477.6	17728	-8.98	18490.8	-5.07	18510.3	-4.97			
P4	8653.53	9053.15	4.62	9431.57	8.99	9441.13	9.10			

ตารางที่ 5.6 เปรียบเทียบแรงดันเกินสวิตชิ่ง (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1)

หมายเหตุ P2 คือ แรงดันระหว่างหน้าตัวเหนี่ยวนำกับกราวด์

P34 คือ แรงดันคร่อมชุดตัวเก็บประจุ

P4 คือ แรงดันระหว่างนิวทรอลกับกราวด์

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





จากการเปรียบเทียบรูปคลื่นพบว่ารูปคลื่นที่ตรวจวัดมีการคายประจุเร็วกว่ารูปคลื่นที่ได้ จากการจำลอง เนื่องจากโวลเตจดิไวเดอร์ที่ใช้ตรวจวัดเป็นชนิดตัวเก็บประจุจึงมีการคายประจุค้าง ผ่านความต้านทานของออสซิโลสโคปจึงทำให้รูปคลื่นที่ตรวจวัดได้มีการคายประจุเร็วกว่าปรกติ

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3

เป็นกรณีการสับชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back โดยทำการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ ชุดที่ 1 และ 2 ก่อนแล้วจึงสับชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 เป็นชุดสุดท้าย เหตุที่ทำเช่นนี้เพื่อสะดวกใน การติดตั้ง ซึ่งการสับสวิตช์นี้จะไม่แสดงรูปคลื่นที่จุดนิวทรอล (P4) เนื่องจากมีค่าต่ำ โดยเปรียบ เทียบค่าที่ได้จากการตรวจวัดกับผลการจำลอง สำหรับรูปคลื่นแรงดันและกระแสจากการตรวจวัด และการจำลองทั้งสามแบบจำลองแสดงดังรูปที่ 5.14 ถึง 5.17

Point	Peak Voltage (V)									
TOIL	Measure	Model 1	% error	Model 2	% error	Model 3	% error			
P1	18476.91	18297.46	-0.97	19508.09	5.58	19539.81	5.75			
P2	20404.78	18297.46	-10.33	19508.09	-4.39	19539.81	-4.24			
P34	20058.98	19947.06	-0.56	21215.31	5.76	21240.67	5.89			

ตารางที่ 5.7 เปรียบเทียบแรงดันเกินสวิตซิ่ง (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)

ตารางที่ 5.8 เปรียบเทียบกระแสเกินสวิตชิ่ง (สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)

Point		Peak Current (A)								
FUIII	Measure	Model 1	% error	Model 2	% error	Model 3	% error			
C34	1456.17	1622.76	11.44	1650.55	13.35	1652.26	13.47			

หมายเหตุ P1 คือ แรงดันระหว่างบัสเทียบกับกราวด์

P2 คือ แรงดันระหว่างหน้าตัวเหนี่ยวนำกับกราวด์

P34 คือ แรงดันตกคร่อมชุดตัวเก็บประจุ

C34 คือ กระแสไหลผ่านชุดตัวเก็บประจุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย





การปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3

สำหรับการปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 นั้นจะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 โดย ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 และ 2 ยังคงต่ออยู่กับวงจร และจะไม่แสดงรูปคลื่นจุด P1 เพราะในการ ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุนั้น แรงดันที่ P1 ซึ่งเป็นแรงดันที่บัสไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปคลื่นแรง ดันและกระแสจากการตรวจวัดและการจำลองทั้งสามแบบจำลองแสดงดังรูปที่ 5.18 ถึง 5.20

Deint	Peak Voltage (V)									
FUIIL	Measure	Model 1	% error	Model 2	% error	Model 3	% error			
P2	19238.8	18065.9	-6.10	18844.1	-2.05	18865.8	-1.94			
P34	19533.9	18074.8	-7.47	18853.4	-3.48	18875.1	-3.37			
P4	8520.4	8848.77	3.85	9213.65	8.14	9223.23	8.25			

ตารางที่ 5.9 เปรียบเทียบแรงดันเกินสวิตชิ่ง (ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3)

หมายเหตุ P2 คือ แรงดันระหว่างหน้าตัวเหนี่ยวนำกับกราวด์

P34 คือ แรงดันคร่อมชุดตัวเก็บประจุ

P4 คือ แรงดันระหว่างนิวทรอลกับกราวด์







จากการเปรียบเทียบรูปคลื่นพบว่ารูปคลื่นที่ตรวจวัดมีการคายประจุเร็วกว่ารูปคลื่นที่ได้ จากการจำลอง เนื่องจากโวลเตจดิไวเดอร์ที่ใช้ตรวจวัดเป็นชนิดตัวเก็บประจุจึงมีการคายประจุค้าง ผ่านความต้านทานของออสซิโลสโคปจึงทำให้รูปคลื่นที่ตรวจวัดได้มีการคายประจุเร็วกว่าปรกติ

สรุปผลการเปรียบเทียบ

จากตารางที่ 5.4 ถึง 5.9 พบว่าค่าแรงดันเกินสวิตซิ่งที่ได้จากการตรวจวัดมีค่าแตกต่าง จากค่าที่ได้จากการจำลองทั้งสามแบบไม่เกิน 11% สำหรับการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุและไม่เกิน 9% สำหรับการปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุ สำหรับค่ากระแสเกินสวิตซิ่งนั้นค่าที่ได้จากการตรวจวัด มีความแตกต่างจากค่าที่ได้จากการจำลองทั้งสามแบบไม่เกิน 48% สำหรับการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บ ประจุชุดที่ 1 และไม่เกิน 14% สำหรับการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 ซึ่งความผิดพลาดนี้อาจ มีสาเหตุดังนี้

- 1. โหลดในระบบจริงเป็นโหลดไม่สมดุล
- ขนาดของพารามิเตอร์และโหลดในระบบขณะทำการตรวจวัดอาจมีค่าเปลี่ยนไปจาก ค่าที่ใช้ในการจำลอง

3. ไม่ทราบเวลาในการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุของเฟสอื่นๆ

 มีคลื่นรบกวนเข้ามาพร้อมกับรูปคลื่นแรงดันขณะทำการตรวจวัด ทำให้เมื่อคำนวณหา กระแสเกินสวิตชิ่ง จึงรวมคลื่นรบกวนเข้าไปด้วยเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด

และพบว่าการจำลองทั้ง 3 แบบให้ผลที่ใกล้เคียงกัน ฉะนั้นเลือกแบบจำลองที่ 1 มาใช้ใน การศึกษาต่อไปเพราะเป็นแบบจำลองที่สะดวกต่อการใช้งานและมีความยุ่งยากในการจำลองน้อย กว่าแบบอื่นๆ

5.3 ผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆในวงจรเมื่อสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

เพื่อศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในแบบจำลองว่ามีผลต่อขนาดแรงดันและกระแส เกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับชุดตัวเก็บประจุมากน้อยเพียงใด โดยมีเงื่อนไขในการจำลองดังนี้

1. กำหนดให้มีโหลดขนาด 13.5 MW และ 5.2 Mvar ยกเว้นกรณีการศึกษาผลของโหลด

2. การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุใช้เวลาในการสับสวิตช์เข้าพร้อมกันทั้งสามเฟส

3. ทุกกรณีจะนำค่าแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งของเฟส A มาพิจารณา

4. สับสวิตช์ที่มุม 90 องศาของรูปคลื่นแรงดันเฟส A ยกเว้นกรณีการศึกษาผลของมุมที่สับ

สวิตช์

5. จะแสดงผล 3 จุด คือแรงดันที่บัสแสดงเป็นแรงดันบัสเทียบกับกราวด์ ส่วนแรงดันที่ชุด ตัวเก็บประจุแสดงแรงดันคร่อมชุดตัวเก็บประจุของชุดที่สับสวิตช์ สำหรับกระแสจะแสดงกระแส ใหลผ่านชุดตัวเก็บประจุของชุดที่สับสวิตช์ โดยกำหนดให้ แรงดัน 1 p.u. = 17.963 kV และ กระแส 1 p.u. = 90 A

6. ชุดที่ 1 หมายถึง การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1

ชุดที่ 2 หมายถึง การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ <mark>2 โ</mark>ดยชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 ต่ออยู่ กับวงจรก่อนแล้ว

ชุดที่ 3 หมายถึง การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 โดยชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 และ 2 ต่ออยู่กับวงจรก่อนแล้ว

5.3.1 มุมที่สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

เพื่อศึกษาแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนมุมที่สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ โดยเปลี่ยนมุมในการสับสวิตช์ของแรงดันเฟส A ตั้งแต่ 0 ถึง 360 องศา



รูปที่ 5.23 กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนมุมสับสวิตช์

จากรูปที่ 5.21 ถึง 5.23 พบว่า

 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 จะเกิดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อสับสวิตช์ที่ มุม 90 องศา แต่ในการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 และ 3 จะเกิดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัส เมื่อสับสวิตช์ที่มุม 75 องศาโดยมีขนาดแรงดัน 1.48, 1.28 และ 1.21 p.u. ตามลำดับ สาเหตุที่เป็น เช่นนี้เพราะการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 และ 3 หรือการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back นั้น ชุดตัวเก็บประจุที่ใช้งานอยู่นอกจากลดค่า dv/dt แล้วยังเพิ่มเวลาขาขึ้น (rise time) ของส่วนพุ่งเกิน (overshoot) ทำให้เมื่อสับสวิตช์ที่มุม 75 องศา แต่ส่วนพุ่งเกินซึ่งเป็นส่วนที่ เกิดแรงดันเกินกลับเกิดที่ประมาณมุม 90 องศา ในขณะที่การสับชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 หรือการ สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวเวลาขาขึ้นของส่วนพุ่งเกินมีค่าน้อย ส่งผลให้เมื่อสับสวิตช์ที่ มุมใด ส่วนพุ่งเกินก็เกิดขึ้นที่ใกล้กับมุมที่สับสวิตช์

2. การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 และ 2 จะเกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บ ประจุเมื่อสับสวิตช์ที่มุม 90 องศา โดยมีขนาดแรงดัน 1.5, 1.66 p.u. ตามลำดับ แต่ในการสับ สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 จะเกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อสับสวิตช์ที่มุม 75 องศาและมีขนาดแรงดัน 1.7 p.u. แต่ก็ใกล้เคียงกับแรงดันเกินสวิตชิ่งเมื่อสับสวิตช์ที่มุม 90 องศา ซึ่งมีค่า 1.69 p.u. และจากการจำลองการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุทั้งแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back นั้นแรงดันเกินที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อสับสวิตช์ที่มุม 75 และ 90 องศามีค่าใกล้เคียง กันมาก

 การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3 จะเกิดกระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อสับ สวิตช์ที่มุม 90 องศาและมีขนาดกระแส 10.33, 41.74 และ 54.22 p.u. ตามลำดับ จะเห็นว่าการ สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back นั้นทำให้เกิดกระแสเกินสวิตชิ่งหรือกระแสพุ่งเข้าสูง กว่าการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว

จากการผลการจำลองพบว่าการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 ทำให้เกิดแรงดันเกินสวิต ชิ่งที่บัสสูงที่สุด รองลงมาเป็นการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 และ 3 หรือการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back นั้นจะมีการลดค่า <u>dv</u> ที่เกิดขึ้นทำให้ส่วนพุ่งเกินมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บ ประจุชุดที่ 1 หรือการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว แต่การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 ทำให้เกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่ชุดตัวเก็บประจุและกระแสเกินสวิตชิ่งสูงที่สุด รองลงมาเป็นการสับ สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 และ 1 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back นั้นจะเกิดการถ่ายเทพลังงานระหว่างชุดตัวเก็บประจุที่ต่อกับวงจรก่อนอยู่แล้วกับ ชุดตัวเก็บประจุที่จะสับสวิตช์เข้าใหม่ ทำให้เกิดออสซิเลชั่นสูงที่ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว จึงสามารถสรุปได้ว่าแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งจะมีขนาดสูง เมื่อสับสวิตซ์ในขณะแรง ดันที่บัสมีค่าใกล้แรงดันค่ายอด ในทางกลับกันแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งจะมีขนาดต่ำ เมื่อสับ สวิตซ์ในขณะแรงดันที่บัสมีค่าใกล้ศูนย์

5.3.2 ขนาดของอิมพีแดนซ์ลัดวงจรของระบบ

เพื่อศึกษาแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของอิมพีแดนซ์ลัดวงจร ของระบบ (Zsc)



รูปที่ 5.24 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์



รูปที่ 5.25 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์



จากรูปที่ 5.24 ถึง 5.26 สามารถสรุปได้ว่าเมื่อค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจรเพิ่มขึ้นหรืออีกนัย หนึ่งระบบมีความแข็งแรงขึ้นจะส่งผลให้

1. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลง ทั้งการสับสวิตช์ชุด ตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back

2. ขนาดกระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดนั้นมีค่าลดลงเล็กน้อย ทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ แบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back

5.3.3 ขนาดของอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่ง

เพื่อศึกษาแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของอิมพีแดนซ์เสิร์จ ของสายส่ง (Zt) ซึ่งเป็นสายส่งที่ต่อเข้ามายังสถานีไฟฟ้าด้านวงจรป้อน



รูปที่ 5.27 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ



รูปที่ 5.28 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ



รูปที่ 5.29 กระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ

จากรูปที่ 5.27 ถึง 5.29 สรุปผลได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่งมีผลต่อ ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุ รวมทั้งขนาดกระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดเล็ก น้อยทั้งการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back

5.3.4 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำ

เพื่อศึกษาแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของตัวเหนี่ยวนำ (L) ซึ่ง เป็นตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ



รูปที่ 5.31 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ



จากรูปที่ 5.30 ถึง 5.32 สรุปได้ว่าเมื่อค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ 1. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง และยังช่วยลดค่า <mark>dv</mark> ที่เกิดขึ้นอีกด้วย ทั้ง การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back

2. ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น และทำให้รูปคลื่นมีลักษณะ ผิดเพี้ยนไปอีกด้วย ทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back

 3. ขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งมีค่าลดลงอย่างมากและรูปคลื่นมีลักษณะผิดเพี้ยนไป สำหรับ การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back ในขณะที่ขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งมีค่าลดลงเล็ก น้อยและรูปคลื่นมีลักษณะผิดเพี้ยนไป สำหรับการสับชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว

5.3.5 ขนาดของชุดตัวเก็บประจุ

เพื่อศึกษาแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (C)



รูปที่ 5.33 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ





จากรูปที่ 5.33 ถึง 5.35 สรุปผลได้ว่าเมื่อค่าชุดตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้

 ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าเพิ่มขึ้น สำหรับการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ แบบแยกเดี่ยว ส่วนการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูง สุดที่บัสจะมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

2. ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บ ประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back

 3. ขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back มีค่าเพิ่ม ขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งของการสับชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวเพิ่มขึ้น เล็กน้อย

5.3.6 ขนาดของโหลด

เพื่อศึกษาแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของโหลดและค่าตัว ประกอบกำลัง 0.8 และ 0.9



รูปที่ 5.36 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8)



รูปที่ 5.37 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9)



รูปที่ 5.38 แรงดันเกินสวิตซิ่<mark>งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บ</mark>ประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8)



รูปที่ 5.39 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9)



รูปที่ 5.41 กระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9)

จากรูปที่ 5.36 ถึง 5.41 สรุปผลได้ว่าเมื่อโหลดมีค่าเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้

 1. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลงอย่างมาก สำหรับการ สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว ส่วนการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุจะลดลงแต่ลดไม่มากเท่าในกรณีการสับ สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว

2. ขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บ ประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back

ค่าตัวประกอบกำลังที่ 0.8 และ 0.9 มีผลต่อขนาดของแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งที่
 เกิดขึ้นน้อยมาก ทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back
5.4 ผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรเมื่อปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุ

เพื่อศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในแบบจำลองว่ามีผลต่อขนาดแรงดันและกระแส เกินสวิตซิ่งเนื่องจากการปลดชุดตัวเก็บประจุมากน้อยเพียงใด โดยศึกษากรณีการเกิดอาร์กซ้ำสอง เฟส เนื่องจากในการต่อชุดตัวเก็บประจุแบบวายไม่ต่อลงดินนั้น เมื่อให้เฟส A เป็นเฟสแรกที่ปลด สวิตซ์ หากเฟส A เกิดอาร์กซ้ำก็จะทำให้แรงดันคร่อมสวิตซ์ที่ เฟส C มีค่าสูงขึ้นประมาณ 4 p.u. ทำให้เฟส C มีโอกาสเกิดอาร์กซ้ำได้สูง ในขณะที่เฟส B จะมีแรงดันตกคร่อมสวิตซ์ไม่สูงมากเท่า กับเฟส C ดังรูปที่ 5.42 และ 5.43 สำหรับการเกิดอาร์กซ้ำจะจำลองด้วยสวิตซ์ 2 ชุดต่อเฟสที่เกิด อาร์กซ้ำ โดยเฟส A ให้สวิตซ์ชุดแรกเปิดเมื่อแรงดันที่เฟส A มีค่าเท่ากับค่าแรงดันค่ายอด และ สวิตซ์ชุดที่สองจะปิดเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งรอบ สำหรับเฟส C สวิตซ์ชุดแรกเปิดเมื่อกระแสผ่านศูนย์ หลังเฟส A เปิด และสวิตซ์ชุดที่สองจะปิดเมื่อเฟส A เกิดอาร์กซ้ำ



รูปที่ 5.43 แรงดันคร่อมตัวชุดเก็บประจุเมื่อเฟส A และเฟส C เกิดอาร์กซ้ำ

การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ในกรณีการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสมีเงื่อนไขดังนี้

- 1. กำหนดให้มีโหลดขนาด 13.5 MW และ 5.2 Mvar ยกเว้นกรณีการศึกษาผลของโหลด
- 2. เฟสที่เกิดอาร์กซ้ำจากการปลดสวิตช์ คือเกิดที่เฟส A และเฟส C

3. ทุกกรณีจะนำค่าแรงดันเกินสวิตชิ่งของเฟส A และ เฟส C มาพิจารณา

4. จะแสดงผล 2 จุด คือแรงดันที่บัสแสดงเป็นแรงดันบัสเทียบกับกราวด์ ส่วนแรงดันที่ชุด ตัวเก็บประจุแสดงแรงดันคร่อมชุดตัวเก็บประจุของชุดที่ปลดสวิตช์

โดยกำหนดให้ แรงดัน 1 p.u. = 17963 V

5. ชุดที่ 1 หมายถึง การปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1

ชุดที่ 2 หมายถึง การปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 โดยชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 ยังคง ต่ออยู่กับวงจร

ชุดที่ 3 หมายถึง การปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 โดยชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 และ 2 ยังคงต่ออยู่กับวงจร

5.4.1 ขนาดของอิมพีแ<mark>ดนซ์ลัดวงจรของร</mark>ะบบ

เพื่อศึกษาแรงดันเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของอิมพีแดนซ์ลัดวงจรของระบบ (Zsc)



รูปที่ 5.44 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส A)



รูปที่ 5.45 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส A)

จากรูปที่ 5.44 ถึง 5.45 สามารถสรุปได้ว่าเมื่อค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจรเพิ่มขึ้นหรืออีก นัยหนึ่งระบบมีความแข็งแรงขึ้นจะส่งผลให้

 ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

 ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลงเล็กน้อย ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำ สองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3



รูปที่ 5.46 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส C)



รูปที่ 5.47 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์ (เฟส C)

จากรูปที่ 5.46 ถึง 5.47 สามารถสรุปได้ว่าเมื่อค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจรเพิ่มขึ้นหรืออีก นัยหนึ่งระบบมีความแข็งแรงขึ้นจะส่งผลให้

 ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3 ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลง สำหรับการเกิดอาร์กซ้ำสอง
เฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 แต่มีค่าลดลงเล็กน้อยสำหรับชุดที่ 2 และ 3

5.4.2 ขนาดของอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่ง

เพื่อศึกษาแรงดันเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่ง (Zt) ซึ่งเป็นสายส่งที่ต่อเข้ามายังสถานีไฟฟ้าด้านวงจรป้อน



รูปที่ 5.48 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส A)



รูปที่ 5.49 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส A)

จากรูปที่ 5.48 ถึง 5.49 สรุปผลได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่งส่งผลต่อ ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุเล็กน้อยทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะ ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3



รูปที่ 5.50 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส C)



รูปที่ 5.51 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดอิมพีแดนซ์เสิร์จ (เฟส C)

จากรูปที่ 5.50 ถึง 5.51 สรุปผลได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่งส่งผลต่อ ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุเล็กน้อยทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะ ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3

ุสถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.4.3 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำ

เพื่อศึกษาแรงดันเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของตัวเหนี่ยวนำ (L) ซึ่งเป็นตัว เหนี่ยวนำต่ออนุกรมชุดตัวเก็บประจุ



รูปที่ 5.52 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ (เฟส A)



รูปที่ 5.53 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ (เฟล A)

จากรูปที่ 5.52 ถึง 5.53 สรุปได้ว่าเมื่อค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ 1. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3

 2. ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟส ขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3



รูปที่ 5.54 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ (เฟส C)



รูปที่ 5.55 แรงดันเกินสวิตซิ่งสู<mark>งสุดที่ชุดตัวเก็บปร</mark>ะจุเมื่อเปลี่ยนขนาดตัวเหนี่ยวนำ (เฟส C)

จากรูปที่ 5.54 ถึง 5.55 สรุปได้ว่าเมื่อค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ 1. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3

 2. ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟส ขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

5.4.4 ขนาดของชุดตัวเก็บประจุ

เพื่อศึกษาแรงดันเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (C)



รูปที่ 5.56 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (เฟส A)



รูปที่ 5.57 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (เฟส A)

จากรูปที่ 5.56 ถึง 5.57 สรุปได้ว่าเมื่อค่าชุดตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ 1. ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3

2. ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น สำหรับการเกิดอาร์กซ้ำสอง เฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 แต่มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับชุดที่ 2 และ 3



รูปที่ 5.58 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (เฟส C)



รูปที่ 5.59 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดชุดตัวเก็บประจุ (เฟส C)

จากรูปที่ 5.58 ถึง 5.59 สรุปได้ว่าเมื่อค่าชุดตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ 1. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3

 2. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น สำหรับการเกิดอาร์กซ้ำสอง เฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 แต่มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับชุดที่ 2 และ 3

5.4.5 ขนาดของโหลด

เพื่อศึกษาแรงดันเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของโหลดและค่าตัวประกอบกำลัง 0.8 และ 0.9



รูปที่ 5.60 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8) (เฟส A)





รูปที่ 5.62 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.8) (เฟส A)



รูปที่ 5.63 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (p.f. 0.9) (เฟส A)

จากรูปที่ 5.60 ถึง 5.63 สรุปผลได้ว่าเมื่อโหลดมีค่าเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้

 ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลง สำหรับการเกิดอาร์กซ้ำสอง
เฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 แต่มีค่าลดลงเล็กน้อยสำหรับชุดที่ 2 และ 3

3. ค่าตัวประกอบกำลัง 0.8 และ 0.9 มีผลต่อขนาดของแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งที่เกิด
ขึ้นน้อยมาก ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3



รูปที่ 5.64 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.8



รูปที่ 5.65 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.9



รูปที่ 5.66 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.8



รูปที่ 5.67 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเปลี่ยนขนาดโหลด (เฟส C)0.9

จากรูปที่ 5.64 ถึง 5.67 สรุปผลได้ว่าเมื่อโหลดมีค่าเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้

 ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลด สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3 2. ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลง สำหรับการเกิดอาร์กซ้ำเนื่อง จากการปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 แต่มีค่าลดลงเล็กน้อยสำหรับชุดที่ 2 และ 3
3. ค่าตัวประกอบกำลัง 0.8 และ 0.9 มีผลต่อขนาดของแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งที่เกิด ขึ้นน้อยมาก ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 6

การศึกษาวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจาก การสับและปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุของกรณีศึกษา

บทนี้จะนำวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งจากที่ได้กล่าวในบทที่ 3 มาใช้กับ กรณีศึกษา เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมกับการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจากสับและ ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

6.1 การควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุ

6.1.1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ (Pre-insertion resistor)

จากบทที่ 3 ขนาดของตัวต้านทานที่เหมาะสม

 $R_{optimun} \approx \sqrt{\frac{1}{C}}$

สามารถประมาณค่าความเหนี่ยวนำของระบบ (L) ได้จากการรวมค่าความเหนี่ยวนำของ อิมพีแดนซ์ลัดวงจรกับค่าความเหนี่ยวนำของหม้อแปลง

29.1953 + 102.8363 = 132.0316 mH

จากนั้นแปลงให้อยู่ในด้านแรงดัน 22 kV

$$132.0316 \left(\frac{22}{115}\right)^2 = 4.832 \,\mathrm{mH}$$

ฉะนั้นจะได้

$$\mathsf{R}_{\mathsf{optimun}} \approx \sqrt{\frac{4.832 \mathrm{mH}}{15.783 \, \mathrm{\mu F}}} = 17.5 \Omega$$

รูปที่ 6.1 ถึง 6.3 แสดงผลของการใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ที่ขนาดต่างๆ



รูปที่ 6.2 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อใช้ตัวต้านทานขนาดต่างๆ



จากผลพบว่าเมื่อขนาดตัวต้านทานเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งที่บัสและที่ชุดตัวเก็บ ประจุรวมทั้งขนาดกระแสเกินสวิตซิ่งจะมีขนาดลดลง แต่เมื่อใช้ตัวต้านทานมากกว่า 17.5 Ω ขนาดแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งจะลดลงไม่มากนัก ซึ่งการใช้ตัวต้านทาน 17.5 Ω ช่วยลดแรง ดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการสับชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3 โดยส่งผลให้แรงดันที่ บัสมีค่า 1.12 ,1.14 และ 1.09 p.u. ตามลำดับ สำหรับแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่า 1.04, 1.08 และ 1.06 p.u. ตามลำดับ สำหรับกระแสมีค่า 5.48, 9.74 และ 10.3 p.u. ตามลำดับ และในกรณี การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back หรือการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 หรือ 3 นั้นการใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ช่วยลดแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งได้ดีแม้จะใช้ตัวต้านทาน ขนาดเล็ก ส่วนการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว หรือการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว หรือการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์จะช่วยลดแรงดันเกินสวิตชิ่งได้ดีแต่ลดกระแสเกินสวิตชิ่งได้ไม่มาก นัก

6.1.2 การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ (Pre-insertion inductor)

จากบทที่ 3 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำที่เหมาะสมประมาณสองเท่าของตัวเหนี่ยวนำของ ระบบ ซึ่งได้ค่าประมาณ 9.66 mH



รูปที่ 6.4 ถึง 6.6 แสดงผลของการใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ที่ขนาดต่างๆ

รูปที่ 6.4 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อใช้ตัวเหนี่ยวนำขนาดต่างๆ



รูปที่ 6.5 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อใช้ตัวเหนี่ยวนำขนาดต่างๆ



จากผลพบว่าเมื่อใช้ขนาดความเหนี่ยวนำประมาณ 9.66 mH สามารถจะลดแรงดันเกิน สวิตซิ่งที่บัสได้พอสมควรในการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว แต่กลับไปเพิ่มแรงดันเกิน สวิตซิ่งที่บัสในการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุแบบ back to back สำหรับแรงดันเกินสวิตซิ่งที่ชุดตัว เก็บประจุจะเพิ่มขึ้นแต่กระแสเกินชั่วขณะจะลดลงทั้งการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยว และแบบ back to back ซึ่งการใช้ตัวเหนี่ยวนำ 9.66 mH ช่วยลดแรงดันและกระแสสวิตซิ่งเนื่อง จากการสับชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3 โดยส่งผลให้แรงดันที่บัสมีค่า 1.17, 1.27 และ 1.33 p.u. ตามลำดับ สำหรับแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่า 1.83, 1.68 และ 1.62 p.u. ตามลำดับ สำหรับกระแสมีค่า 6.5, 6.38 และ 6.95 p.u. ตามลำดับ

6.1.3 การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุ

จากบทที่ 3 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำที่เหมาะสม ประมาณ 6 % หรือ 7 %ของชุดตัวเก็บ ประจุ

รูปที่ 6.7 ถึง 6.9 แสดงผลของการใช้ตัวเหนี่ยวน้ำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุที่ขนาดต่างๆ





รูปที่ 6.8 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อใช้ขนาดตัวเหนี่ยวนำต่างๆ



จากผลพบว่าการใช้ตัวเหนี่ยวนำ 7% สามารถลดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่บัสได้ดี แต่จะทำให้ แรงดันเกินสวิตชิ่งที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น สำหรับกระแสเกินสวิตชิ่งมีค่าลดลง ทั้งการสับ สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back ซึ่งการใช้ตัวเหนี่ยวนำ 7 % ช่วยลด แรงดันและกระแสสวิตชิ่งเนื่องจากการสับชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3 โดยส่งผลให้แรงดันที่ บัสมีค่า 1.04, 1.02 และ 1.01 p.u. ตามลำดับ สำหรับแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่า 1.88, 1.81 และ 1.8 p.u. ตามลำดับ สำหรับกระแสมีค่า 4.64, 4.65 และ 4.67 p.u. ตามลำดับ

6.1.4 การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ (Synchronous Closing Control)

ผลของการใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตซ์สามารถลดแรงดันเกินสวิตซิ่งที่บัสและชุดตัวเก็บ ประจุรวมทั้งกระแสเกินสวิตซิ่งได้ดีทั้งการสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back ซึ่งการใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ช่วยลดแรงดันและกระแสสวิตซิ่งเนื่องจากการสับชุดตัว เก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3 โดยส่งผลให้แรงดันที่บัสมีค่า 1.01, 1.01 และ 1.02 p.u. ตามลำดับ สำหรับแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่า 1.01, 1.01และ 1.02 p.u. ตามลำดับ สำหรับกระแสมีค่า 1.37, 2.16 และ 2.46 p.u. ตามลำดับแต่หากเกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการสับสวิตช์ชุด ตัวเก็บประจุอาจทำให้เกิดแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งมีขนาดสูง

รูปที่ 6.10 ถึง 6.12 แสดงผลของเวลาคลาดเคลื่อนในการสับสวิตช์เมื่อการปิดสวิตช์ของ เฟส A และเฟส B เกิดการคลาดเคลื่อน



รูปที่ 6.10 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนต่างๆ



รูปที่ 6.11 แรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนต่างๆ



รูปที่ 6.12 กระแส<mark>เกินสวิต</mark>ชิ่งสูงสุดเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนต่างๆ

จากผลพบว่าหากความคลาดเคลื่อนของเวลาในการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุของเฟส A และ B อยู่ในช่วง ± 1 ms แรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งจะมีขนาดไม่มาก

6.1.5 เปรียบเทียบผลการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งด้วยวิธีการต่างๆ

จากวิธีการทั้งหมดจะนำมาผลมาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีการที่สามารถลดแรงดันและ กระแสเกินสวิตซิ่งได้ดีที่สุด โดยกำหนดให้

- วิธีที่ 1 คือ ไม่มีการควบคุม
- วิธีที่ 2 คือ การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ (Pre-insertion resistor)
- วิธีที่ 3 คือ การใช้ตัวเหนี่ยวน้ำขนานสวิตช์ (Pre-insertion inductor)
- วิธีที่ 4 คือ การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุ
- วิธีที่ 5 คือ การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ (Synchronous Closing Control)



รูปที่ 6.13 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัส









รูปที่ 6.16 รูปคลื่นแรงดันที่บัสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1



รูปที่ 6.17 รูปคลื่นแรงดันที่บัสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2



รูปที่ 6.18 รูปคลื่นแรงดันที่บัสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3



รูปที่ 6.19 รูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1



รูปที่ 6.20 รูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2



รูปที่ 6.21 รูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3



รูปที่ 6.22 รูปคลื่นกระแสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1



รูปที่ 6.23 รูปคลื่นกระแสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2



รูปที่ 6.24 รูปคลื่นกระแสจากวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งต่างๆ ของการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3

สรุปผลการเปรียบเทียบ

จากรูปที่ 6.13 ถึง 6.24 พบว่าผลการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการ สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุทั้งแบบแยกเดี่ยวและแบบ back to back มีแนวโน้มเหมือนกันคือ

 การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์และการใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุทำให้ แรงดันเกินสวิตชิ่งที่บัสมีขนาดต่ำและรูปคลื่นแรงดันที่บัสมีออสซิเลชั่นน้อยที่สุด รองลงมาเป็นการ ใช้ความต้านทานขนานสวิตช์และการใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ตามลำดับ

2. การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์และการใช้ความต้านทานขนานสวิตช์ทำให้แรงดันเกินสวิต ชิ่งที่ชุดตัวเก็บประจุมีขนาดต่ำและรูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุมีการออสซิเลชั่นน้อยที่สุด รอง ลงมาเป็นการใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ซึ่งจะมีขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งและการออสซิเลชั่นสูงกว่า สำหรับการใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุนอกจากทำให้แรงดันเกินสวิตชิ่งมีขนาด สูงแล้วก็ทำให้รูปคลื่นแรงดันมีความผิดเพี้ยนด้วย

3. การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ทำให้รูปคลื่นกระแสมีออสซิเลชั่นมากในช่วงแรก แต่มีขนาด กระแสเกินสวิตชิ่งต่ำ ในขณะที่การใช้ความต้านทานขนานสวิตช์และการใช้ตัวเหนี่ยวนำขนาน สวิตช์จะมีขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งสูงกว่าแต่มีการออสซิเลชั่นต่ำกว่า สำหรับการใช้ตัวเหนี่ยวนำต่อ อนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุแม้ว่าจะทำให้ขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งมีขนาดต่ำ แต่ก็ทำให้รูปคลื่น กระแสมีความผิดเพี้ยน

ดังนั้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์สามารถลดการเกิดแรง ดันและกระแสเกินสวิตชิ่งได้ดีที่สุด รองมาคือการใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ ในขณะที่การใช้ตัว เหนี่ยวนำขนานสวิตช์และการใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุสามารถลดแรงดันเกิน สวิตชิ่งที่บัสได้ แต่ส่งผลให้เกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าสูง

6.2 การควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ

6.2.1 กับดักฟ้าผ่าแบบ MOV

กับดักฟ้าผ่าจะใช้ในการป้องกันการเกิดอาร์กซ้ำเนื่องจากการปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุ ซึ่ง กับดักฟ้าผ่าสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะทำการพิจารณา 3 รูปแบบได้แก่ กับดักฟ้าผ่า ต่อระหว่างเฟส-กราวด์, เฟส-นิวทรอล , เฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ ดังแสดงในรูปที่ 6.25 ถึง 6.27 โดยจำลองให้เกิดอาร์กซ้ำสองเฟสเนื่องจากเป็นการเกิดอาร์กซ้ำที่มีความรุนแรง โดยให้ เฟส A และเฟส C เป็นเฟสที่เกิดอาร์กซ้ำ และชุดตัวเก็บประจุมีประจุค้างเต็มก่อนที่จะเกิดอาร์กซ้ำ และพิจารณาเฉพาะกรณีการปลดชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 เมื่อไม่มีโหลดเพราะเกิดแรงดันเกินเนื่อง จากอาร์กซ้ำสองเฟสรุนแรงที่สุด ในขณะที่การเกิดอาร์กซ้ำในการปลดชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 เมื่อ ไม่มีโหลด แรงดันเกินคร่อมชุดตัวเก็บประจุที่เกิดขึ้นมีค่า 1.01 สำหรับเฟส A และ 1.43 สำหรับ เฟส C ส่วนอาร์กซ้ำในการปลดชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 เมื่อไม่มีโหลด แรงดันเกินคร่อมชุดตัวเก็บ ประจุที่เกิดขึ้นมีค่า 1.65 สำหรับเฟส A และ 1.43 สำหรับเฟส C จะเห็นได้ว่าแรงดันเกินที่เกิดขึ้น จากอาร์กซ้ำในการปลดชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 และ 3 มีค่าไม่สูงพอที่กับดักฟ้าผ่าจะทำงาน ดังนั้น จึงไม่นำอาร์กซ้ำจากการปลดชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 และ 3 มาศึกษา



รูปที่ 6.25 วงจรในกรณีกับดักฟ้าผ่าต่อแบบเฟส-กราวด์



รูปที่ 6.26 วงจรในกรณีกับดักฟ้าผ่าต่อแบบเฟส-นิวทรอล



รูปที่ 6.27 วงจรในกรณีกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์

ซึ่งสามารถคำนวณเพื่อเลือกขนาดพิกัดของกับดักฟ้าผ่าได้ดังนี้

กรณีต้องการติดตั้งกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-กราวด์

ค่า U_c ต้องมากกว่าหรือเท่ากับแรงดันเฟสและต้องพิจารณาแรงดันเกิน 10 % ด้วยดังนั้น จะได้ว่า

$$U_{c} \ge 1.1 \times \frac{22}{\sqrt{3}} = 13.97 \, \text{kV}$$

ค่า U_r ของกับดักฟ้าผ่าสามารถคำนวณจากบทที่ 3 หัวข้อ 3.5.2.1 กรณีที่ 2 U_r ≥ 0.88 × 1.55 × $\frac{22}{\sqrt{3}}$ = 17.32 kV

สามารถเลือก U_r เท่ากับ 21 kV

ต่อมาคิดค่าพลังงานที่กับดักฟ้าผ่าจะได้รับโดยพิจารณาค่า V_o และ V_a ซึ่ง V_o จะคิดในกรณีที่เกิดอาร์กซ้ำจะเกิดแรงดันเกิน 3 เท่าของค่ายอดแรงดัน

$$V_{o} = 3 \times \sqrt{2} \times \frac{22}{\sqrt{3}} = 53.89 \text{ kV}$$

V_a เลือกค่ายอดแรงดัน U_c

ค่าความเก็บประจุ =15.783 μF

จากค่าที่หามาได้ข้างต้น จะสามารถคำนวณค่าพลังงานได้ดังนี้

E_c = 53.89² - ($\sqrt{2} \times 13.97$)² × $\frac{15.783}{2}$ = 19.84 kJ หรือ 0.9 kJ/kV

สำหรับกับดักฟ้าผ่าแบบเฟส-นิวทรอลหรือเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ใช้ค่าเดียว กับในกรณีกับดักฟ้าผ่าต่อแบบเฟส-กราวด์

6.2.1.1 เปรียบเทียบการติดตั้งกับดักฟ้าผ่าในรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อศึกษาผลของการติดตั้งกับดักฟ้าผ่าในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่าง เฟส-กราวด์, เฟส-นิวทรอล, เฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ เปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการติด ตั้งกับดักฟ้าผ่า โดยใช้ขนาดแรงดันพิกัด 21 kV สำหรับกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างเฟส-กราวด์และ เฟส-นิวทรอล ส่วนกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างนิวทรอล-กราวด์ใช้แรงดันพิกัด 9 kV ซึ่งวิธีเลือกแรงดัน พิกัด 9 kV นี้จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป





รูปที่ 6.28 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัส



รูปที่ 6.29 แรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุ

รูปที่ 6.28 และ 6.29 จะเห็นได้ว่า

 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่าระหว่างเฟส-กราวด์สามารถลดแรงดันเกินสวิตซิ่งที่บัสได้ดีที่สุด ทั้งสองเฟส รองลงมาเป็นกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ และกับดักฟ้า ผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลตามลำดับ

 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่าระหว่างเฟส-กราวด์สามารถลดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่ชุดตัวเก็บ ประจุในเฟส C ได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ และกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลซึ่งลดแรงดันเกินได้เท่ากัน สำหรับเฟส A นั้นกับดักฟ้าผ่า ต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ และกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลลดแรงดัน เกินได้ดีกว่ากับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-กราวด์

สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าหากต้องการลดแรงดันเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการเกิดอาร์กซ้ำ สองเฟสที่บัส การใช้กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-กราวด์สามารถลดแรงดันเกินสวิตซิ่งที่บัสได้ดีที่ สุด แต่หากต้องการลดแรงดันเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสที่ชุดตัวเก็บประจุ การ ใช้กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ หรือการใช้กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่าง เฟส-นิวทรอลสามารถลดแรงดันเกินสวิตซิ่งได้ดีที่สุด โดยพลังงานที่กับดักฟ้าผ่าได้รับมีค่าต่ำกว่า ความสามารถในการรับพลังงานของกับดักฟ้าผ่าในทุกกรณี

6.2.1.2 เปรียบเทียบขนา<mark>ดแรงดันพิ</mark>กัดของกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างนิวทรอล-กราวด์

กรณีกับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์นั้น สามารถเลือกค่าแรง ดันพิกัดของกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างเฟส-นิวทรอลได้ตามที่กล่าวในบทที่ 3 ในกรณีนี้ใช้ 21 kV แต่ไม่มีการกำหนดค่าแรงดันพิกัดของกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างนิวทรอล-กราวด์ ดังนั้นหัวข้อนี้จึง ทดสอบเปลี่ยนขนาดแรงดันพิกัดของกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างนิวทรอล-กราวด์ เพื่อหาขนาดแรง ดันพิกัดที่เหมาะสม





จากรูปที่ 6.30 และ 6.31 พบว่าการต่อกับดักฟ้าผ่าระหว่างนิวทรอล-กราวด์ เมื่อใช้กับดัก ฟ้าผ่าขนาดแรงดันพิกัด 9 kV จะช่วยลดแรงดันเกินจากการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสทั้งที่บัสและตัว เก็บประจุได้ดีกว่าขนาดแรงดันพิกัดที่สูงขึ้นมา


บทที่ 7

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยการเกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับและปลดสวิตช์ ชุดตัวเก็บประจุที่สถานีไฟฟ้าสามารถสรุปได้ดังนี้

1. พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุคือ

1.1 ผลการจำลองพบว่าการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 ทำให้เกิดแรงดัน เกินสวิตชิ่งที่บัสสูงที่สุด โดยมีขนาดแรงดัน 1.48 p.u. รองลงมาเป็นการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ ชุดที่ 2 โดยมีขนาดแรงดัน 1.28 p.u.และการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 โดยมีขนาดแรงดัน 1.21 ตามลำดับ แต่การสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 3 ทำให้เกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่ชุดตัวเก็บ ประจุและกระแสเกินสวิตชิ่งสูงที่สุด โดยมีขนาดแรงดัน 1.70 p.u.และขนาดกระแส 54.22 p.u. รองลงมาเป็นการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 2 โดยมีขนาดแรงดัน 1.66 p.u. และขนาดกระแส 41.74 p.u. และการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 โดยมีขนาดแรงดัน 1.5 และขนาดกระแส 10.33 p.u. ตามลำดับ

1.2 มุมที่สับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ สรุปได้ว่าแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งจะมี ขนาดสูง เมื่อสับสวิตช์ในขณะแรงดันที่บัสมีค่าใกล้แรงดันค่ายอด ในทางกลับกันแรงดันและ กระแสเกินสวิตชิ่งจะมีขนาดต่ำ เมื่อสับสวิตช์ในขณะแรงดันที่บัสมีค่าใกล้ศูนย์ ทั้งการสับสวิตช์ชุด ตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

1.3 ขนาดของอิมพีแดนซ์ลัดวงจรของระบบ สรุปได้ว่าเมื่อขนาดอิมพีแดนซ์ลัดวง
 จรเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลง สำหรับขนาดกระแส
 เกินสวิตซิ่งสูงสุดนั้นมีค่าลดลงเล็กน้อย ทั้งการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

1.4 ขนาดของอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่ง สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ เสิร์จของสายส่งมีผลต่อขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุ รวมทั้งขนาด

กระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดเล็กน้อยทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3 1.5 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำ สรุปได้ว่าเมื่อขนาดตัวเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดัน เกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง แต่ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุจะมีค่าเพิ่มขึ้น สำหรับขนาดกระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดมีค่าลดลง และรูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุและรูปคลื่น กระแสที่เกิดมีลักษณะผิดเพี้ยนไป ทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3 1.6 ขนาดของชุดตัวเก็บประจุ สรุปผลได้ว่าเมื่อขนาดชุดตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุ รวมทั้งขนาดกระแสเกินสวิตชิ่งสูงสุดมีค่า เพิ่มขึ้นทั้งการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

 1.7 ขนาดของโหลด สรุปผลได้ว่าเมื่อโหลดมีค่าเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่ง สูงสุดที่บัสและที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลง ในขณะที่ขนาดกระแสเกินสวิตซิ่งสูงสุดมีการเปลี่ยน แปลงเล็กน้อย สำหรับค่าตัวประกอบกำลัง 0.8 และ 0.9 มีผลต่อขนาดของแรงดันและกระแสเกิน สวิตซิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากทั้งการสับสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุคือ

2.1 ขนาดของอิมพีแดนซ์ลัดวงจรของระบบ สรุปได้ว่าเมื่อขนาดอิมพีแดนซ์ลัดวง
 จรเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง สำหรับขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุด
 ตัวเก็บประจุมีค่าลดลงเล็กน้อย ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1
 , 2 และ 3

2.2 ขนาดของอิมพีแดนซ์เสิร์จของสายส่ง สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ เสิร์จของสายส่งมีผลต่อขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุเล็กน้อยทั้งการเกิด อาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3

2.3 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำ สรุปได้ว่าเมื่อขนาดตัวเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดัน เกินสวิตซิ่งสูงสุดที่บัสมีค่าลดลง แต่ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่งสูงสุดที่ชุดตัวเก็บประจุจะมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1 , 2 และ 3

2.4 ขนาดของชุดตัวเก็บประจุ สรุปผลได้ว่าเมื่อขนาดชุดตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งสูงสุดที่บัสและชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้นทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟส ขณะปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

2.5 ขนาดของโหลด สรุปผลได้ว่าเมื่อโหลดมีค่าเพิ่มขึ้น ขนาดแรงดันเกินสวิตซิ่ง สูงสุดที่บัสและที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าลดลง สำหรับค่าตัวประกอบกำลัง 0.8 และ 0.9 มีผลต่อ ขนาดของแรงดันเกินสวิตซิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากทั้งการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตซ์ชุดตัว เก็บประจุชุดที่ 1, 2 และ 3

 ผลการศึกษาวิธีการควบคุมแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการสับสวิตซ์ชุดตัว เก็บประจุคือ 3.1 การใช้ตัวต้านทานขนานสวิตซ์ (Pre-insertion resistor) ซึ่งใช้ตัวต้านทาน
 ขนาด 17.5 Ω สามารถลดขนาดแรงดันและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บ
 ประจุได้ดีรองจากการใช้ชุดควบคุมการต่อวงจร

3.2 การใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์ (Pre-insertion inductor) ซึ่งใช้ตัวเหนี่ยวนำ ขนาด 9.66 mH สามารถลดขนาดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่บัสและกระแสเกินสวิตชิ่งเนื่องจากการสับ สวิตช์ชุดตัวเก็บประจุได้ดีพอสมควร แต่ส่งผลให้แรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น

3.3 การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุ ซึ่งใช้ตัวเหนี่ยวนำขนาด 7% ของตัวเก็บประจุสามารถลดแรงดันเกินสวิตซิ่งที่บัสและกระแสเกินสวิตซิ่งได้ดี แต่ส่งผลให้แรงดันที่ ชุดตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้รูปคลื่นแรงดันที่ชุดตัวเก็บประจุและรูปคลื่นกระแส มีความผิดเพี้ยนด้วย

3.4 การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์ (Synchronous Closing Control) สามารถ ลดขนาดแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่องจากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุได้ดีที่สุด แต่ ความคลาดเคลื่อนของเวลาในการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุต้องไม่เกินช่วง ±1 ms

3.5 การใช้ชุดควบคุมการปิดสวิตช์สามารถลดแรงดันและกระแสเกินสวิตซิ่งเนื่อง จากการสับสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุได้ดีที่สุด รองมาคือการใช้ตัวต้านทานขนานสวิตช์ ในขณะที่การ ใช้ตัวเหนี่ยวนำขนานสวิตช์และการใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุสามารถลดแรงดัน เกินสวิตชิ่งที่บัสได้ แต่ส่งผลให้เกิดแรงดันเกินสวิตชิ่งที่ชุดตัวเก็บประจุมีค่าสูง

3.6 การใช้กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-กราวด์สามารถลดแรงดันเกินสวิตซิ่งจาก การเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะปลดสวิตซ์ชุดตัวเก็บประจุที่บัสได้ดีที่สุด ในขณะที่กับดักฟ้าผ่าต่อ ระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์ หรือการใช้กับดักฟ้าผ่าต่อระหว่างเฟส-นิวทรอล สามารถลดแรงดันเกินสวิตซิ่งที่ชุดตัวเก็บประจุได้ดีที่สุด

3.7 การต่อกับดักฟ้าผ่าระหว่างเฟส-นิวทรอลและนิวทรอล-กราวด์นั้น กับดักฟ้า ผ่าที่ต่อระหว่างนิวทรอล-กราวด์ หากเลือกขนาดแรงดันพิกัดต่ำกว่าขนาดแรงดันพิกัดของกับดัก ฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างเฟส-นิวทรอล จะช่วยลดแรงดันเกินสวิตซิ่งจากการเกิดอาร์กซ้ำสองเฟสขณะ ปลดสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุทั้งที่บัสและตัวเก็บประจุได้ดีกว่าการใช้ขนาดแรงดันพิกัดเท่ากับแรงดัน พิกัดของกับดักฟ้าผ่าที่ต่อระหว่างเฟส-นิวทรอล

7.2 ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการศึกษาในกรณีศึกษาอื่น ๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองที่ใช้ใน โปรแกรม EMTP/ATP

2. ควรมีการเปรียบเทียบราคาของการใช้วิธีควบคุมแต่ละวิธี

รายการอ้างอิง

- 1 สำรวย สังข์สะอาด. <u>Electrical Transient Overvoltage in Power System</u>. เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ, ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พฤษภาคม 2541.
- 2 IEEE Std 1036-1992 IEEE guide for application of shunt power capacitors, 1993.
- 3 สมโชค บุญชัยศรี. <u>การวิเคราะห์แรงดันเกินชั่วขณะเนื่องจากการต่อวงจรตัวเก็บประจุที่ระดับ</u> <u>แรงดัน 115 กิโลโวลท์</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2542.
- ANSI/IEEE C37.012-1979 <u>IEE Application Guide for Capacitance Current Switching</u> for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Bias, 1980.
- 5 IEC 60871-1 International Standard Shunt Capacitor for A.C. Power Systems Having <u>a Rated Voltage above 1000 V</u>, 2nd Edition, 1997.
- 6 Allan Greenwood. <u>Electrical Transients in Power System</u>. 2nd edition.
 John Wieley & Sons, 1991.
- 7 Ananthakroshnan, S., and Guruprasad, K.P. <u>Transient Recovery Voltage and Circuit</u> <u>Breakers</u>, Tata McGraw-Hill, 1999.
- 8 Skeans, D. W. Recent Developments in Capacitor Switching Transient Reduction. Joslyn Hi-Voltage, (n.d.).
- 9 Bellei, T. A., O'Leary, R. P., and Camm, E.H. Evaluating Capacitor Switching Devices for Preventing Nuisance Tripping of Adjustable Speed Drives Due to Voltage Magnification. <u>IEEE Trans. on Power Delivery</u> vol. 11, no. 3(July 1996): 1373-1378.
- 10 Peggs, J.F., Powell, P.W., and Grebe, T.E. Innovations for Protection and Control of High Voltage Capacitor Banks on the Virginia Power System. <u>Transmission and</u> <u>Distribution Conference</u> (April 1994):284- 290.
- นครินทร์ วงศ์ศศิธร. <u>ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของผู้ใช้จากการสวิตช์ตัวเก็บประจุในระบบ</u> <u>จำหน่ายแรงดันปานกลาง</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

- 12 Das, J.C., Sr. Effect of Medium Voltage Capacitor Bank Switching Surges in an Industrial Distribution System. <u>IEEE Conference Record of the Industrial and</u> <u>Commercial Power Systems Technical Conference</u> (May 1992): 57-64.
- Publication SESWG/A 2312E. <u>Application Guidelines for Shunt Capacitor</u> <u>Overvoltage Control</u>, 1991.
- 14 Reid, W. E., McGanaghan, M.F., Law, S. W., and Greshan, D. W. Overvoltage Protection of Shunt –Capacitor Banks using MOV Arrester. <u>IEEE Trans. On Power</u> <u>Apparatus and System</u> vol. PAS-103, No. 8(August 1984):2326-2336.
- 15 Working Group 3.4.17 of the IEEE Surge Protection Devices Committee. Impact of Shunt Capacitor Banks on Substation Surge Environment and Surge Arrester Applications. <u>IEEE Trans. on Power Delivery</u>, vol. 11, No. 4(October 1996):1798-1809.
- 16 Working Group 3.4.17 of the IEEE Surge Protection Devices Committee. Surge Protection of High Voltage Shunt Capacitor Banks on AC Power Systems Survey Results and Application Considerations. <u>IEEE Trans. on Power Delivery</u> vol. 6, No. 3(July 1991):1065- 1072.
- 17 Hermann W. Dommel, <u>EMTP Theory Book</u>, 2 nd, Microtan Power System Analysis Corporation, 1996.
- 18 สุรพล ดำรงกิตติกุล. หลักการสร้างแบบแทนระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงดัน เกินสวิตชิ่ง. <u>Seminar on Electrical Power System IEEE Thailand Section</u> (ตุลาคม 2529):120-131
- 19 IEEE PES Switching Transient Task Force 15.08.09.03. <u>Task Force Report: Modeling</u> <u>Guidelines for Switching Transients</u>, draft copy (WPM'97)
- 20 Electrotek Concepts. <u>Evaluation of Distribution Capacitor Switching Concerns</u>, Final Report, EPRI TR-107332, October 1997.
- Bayless, R.S., Selman, J.D., Truax, D.E., and Reid, W.E. Capacitor Switching and Transformer Transients. <u>IEEE Trans. on Power Delivery</u> vol. 3, no.1(January 1988): 349- 357.
- 22 Coury, D.V., Dos Santos, C.J., and Tavares, M.C. Transient Analysis Resulting from Shunt Capacitor Switching in an Actual Electrical Distribution System. <u>Harmonics</u> <u>And Quality of Power</u> vol. 1(October 1998): 292- 297.

- 23 Fu, Y.H., Simulation Study on the Switching Transients During De-energisation of Filter and Capacitor Banks. <u>Sixth International Conference on AC and DC Power</u> <u>Transmission</u> no. 423(April-May 1996): 375- 380.
- 24 De Grijp, M.H.B., and Hopkins, R.A. Controlled Switching of Shunt Capacitors. <u>IEEE</u> <u>AFRICON 4th</u> vol. 2(September 1996): 874- 879.
- 25 McCoy, C.E., and Floryancic, B.L. Characteristics and Measurement of Capacitor Switching at Medium Voltage Distribution Level. <u>Petroleum and Chemical</u> <u>Industry Conference</u> (September 1993): 195- 204
- 26 Smith, L.M. A Practical Approach in Substation Capacitor Bank Applications to Caculating, Limiting, and Reducing the Effects of Transient Current. <u>IEEE Trans.</u> <u>on Industry Applications</u> vol. 31, no. 4(July-August 1995): 721-724.
- Shankland, L.A., Feltes, J.W., and Burke, J.J. The Effect of Switching Surges on 34.5
 kV System Design and Equipment. <u>IEEE Trans. on Power Delivery</u> vol. 5, no. 2
 (April 1990): 1106- 1112.
- Adams, R.A., and Middlekauff S.W. Solving Customer Power Quality Problem Due to Voltage Magnification. <u>IEEE Trans. on Power Delivery</u> vol. 13, no. 4(October 1998):1515-1520.
- Zalucki, Z. Restrike and Reignition Voltages of a Short Contact Gap During
 Capacitance Switching Using Vacuum Circuit Breakers. <u>XIXth International</u>
 <u>Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum</u> vol. 1(2000): 56 59.

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

วิธีการหาสมการแรงดันเกินสวิตชิ่งและกระแสเกินสวิตชิ่ง

ก.1 วิธีหาสมการแรงดันเกินสวิตชิ่งและกระแสเกินสวิตชิ่งจากรูปที่ 2.1



จากรูปที่ 2.1 สามารถหาสมการได้

$$iR + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int idt + V_{c}(0) = V_{m}\sin(\omega t + \phi)$$
(n.1)

$$R\frac{di}{dt} + L\frac{d^{2}i}{dt^{2}} + \frac{i}{C} = \omega V_{m} \cos(\omega t + \phi)$$
(n.2)

ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ : $LM^2 + RM + \frac{1}{C} = 0$ $M = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \log n$ ได้ผลคำตอบทั่วไปคือ $I_c = e^{-\alpha t} \left(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t\right)$

(ก.3)

เมื่อ

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$
$$\beta = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)}$$

หาผลคำตอบเฉพาะได้จากนำ I_p = $Asin(\omega t + \phi) + Bcos(\omega t + \phi)$ แทนในสมการ (n.2)

$$\left[\left(-L\omega^{2} + \frac{1}{C}\right)A - R\omega B\right]\sin(\omega t + \phi) + \left[R\omega A + \left(-L\omega^{2} + \frac{1}{C}\right)B\right]\cos(\omega t + \phi) = \omega V_{m}\cos(\omega t + \phi)$$

จะได้สมการ

$$\left(-L\omega^{2} + \frac{1}{C}\right)A - R\omega B = 0 \tag{n.4}$$

$$R\omega A + \left(-L\omega^{2} + \frac{1}{C}\right)B = \omega V_{m}$$
(1.5)

แก้สมการ (ก.4) และ (ก.5) จะได้

$$A = \frac{RV_{m}}{R^{2} + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^{2}}$$

$$B = \frac{(\omega L - \frac{1}{\omega C})V_{m}}{R^{2} + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^{2}}$$
ให้ S = $\omega L - \frac{1}{\omega C}$
จะได้ผลคำตอบเฉพาะคือ $I_{p} = \frac{RV_{m}}{R^{2} + S^{2}}\sin(\omega t + \phi) + \frac{SV_{m}}{R^{2} + S^{2}}\cos(\omega t + \phi)$
จาก Acos x + Bsin x = $\sqrt{A^{2} + B^{2}}\sin(x \pm \delta)$, tan $\delta = \frac{\sin\delta}{\cos\delta} = \pm \frac{A}{B}$
จัดรูปแบบใหม่ได้ผลคำตอบเฉพาะดังนี้

$$I_{p} = \frac{V_{m}}{\sqrt{R^{2} + S^{2}}} \sin\left(\omega t + \phi + \tan^{-1}\left(\frac{S}{R}\right)\right)$$
(n.6)

เมือ

$$Z = \sqrt{R^2 + S^2}, \theta = \tan^{-1}\left(\frac{S}{R}\right)$$

้ได้ผลคำตอบของกระแส<mark>เกินสวิตชิ่งดังนี้</mark>

$$I_{c}(t) = e^{-\alpha t} \left(C_{1} \cos \beta t + C_{2} \sin \beta t \right) + \frac{V_{m}}{Z} \sin \left(\omega t + \phi + \theta \right)$$
(ก.7)
หาค่าคงที่ C_{1} จากเงื่อนไขที่เวลา $t = 0 : I(0) = 0$

$$C_{1} + \frac{V_{m}}{Z} \sin(\phi + \theta) = 0$$
$$C_{1} = -\frac{V_{m}}{Z} \sin(\phi + \theta)$$

หาค่าคงที่ C_2 จากเงื่อนไขที่เวลา t = 0 : I(0) = 0 และ Q(0) = 0 จาก Q = $\int idt$ แทนในสมการ (ก.1)

$$L\frac{di}{dt} = V_{m}\sin(\omega t + \phi) - V_{c}(0) - iR - \frac{Q}{C}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{V_{m}\sin(\omega t + \phi) - V_{c}(0)}{L}$$
(n.8)

แทนสมการ (ก.7) ในสมการ (ก.8)

$$\frac{V_{m}\sin(\omega t + \phi) - V_{c}(0)}{L} = -\alpha C_{1} + \beta C_{2} + \frac{V_{m}\omega}{Z}\cos(\phi + \theta)$$

$$C_{2} = \frac{1}{\beta} \left[\frac{V_{m}\sin(\omega t + \phi) - V_{c}(0)}{L} - \frac{V_{m}}{Z}\sin(\phi + \theta) - \frac{V_{m}\omega}{Z}\cos(\phi + \theta) \right]$$

ได้ผลคำตอบของกระแสเกินสวิตชิ่งดังนี้

$$i_{c}(t) = V_{m} \sin(\omega t + \phi + \theta) + e^{-\alpha t} \begin{bmatrix} -\frac{V_{m}}{Z} \sin(\phi + \theta) \cos\beta t \\ +\frac{\sin\beta t}{\beta} \begin{bmatrix} \frac{V_{m} \sin\phi - V_{c}(0)}{L} \\ -\frac{V_{m}\alpha}{Z} \sin(\phi + \theta) \\ -\frac{V_{m}\omega}{Z} \cos(\phi + \theta) \end{bmatrix}$$

จากนั้นหาแรงดันเกินสวิตชิ่งได้จากสมการ

$$V_{c} = \frac{1}{C} \int i dt$$

จะได้ผลคำตอบของแรง<mark>ดันที่ตัวเก็บประ</mark>จุดังนี้

$$V_{c}(t) = -\frac{V_{m}}{C\omega Z}\cos(\omega t + \phi + \theta)$$

$$+\frac{V_{m}e^{-\alpha t}}{CZ(\alpha^{2} + \beta^{2})} \begin{bmatrix} \sin(\phi + \theta)[\alpha\cos(\beta t) - \beta\sin(\beta t)] \\ +\frac{1}{\beta L} \begin{bmatrix} [\beta\cos(\beta t) + \alpha\sin(\beta t)] \\ [L\omega\cos(\phi + \theta) - Z\sin(\phi)] \\ +\frac{V_{c}(0)Z}{V_{m}} + \alpha L\sin(\phi + \theta) \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก.2 วิธีหาสมการแรงดันเกินสวิตซิ่งและกระแสเกินสวิตซิ่งจากรูปที่ 2.3



จากรูปที่ 2.1 สามารถหาสมการได้

$$L_{1} \frac{dI_{c1}}{dt} + V_{c1} = V_{m} \sin(\omega t + \phi)$$
(n.9)

$$L_{2} \frac{dI_{c2}}{dt} + V_{c2} = V_{c1}$$
(n.10)

$$I_{c2} = C_2 \frac{dV_{c2}}{dt}$$
(n.11)

$$I_{c1} - I_{c2} = C_1 \frac{dV_{c1}}{dt}$$
(n.12)

จัดรูปแบบจากสมการ (n.9), (n.10), (n.11), (n.12)ได้ดังนี้

$$\frac{d^{4}V_{c2}}{dt^{4}} + \left(\frac{1}{L_{1}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{2}}\right)\frac{d^{2}V_{c2}}{dt^{2}} + \frac{V_{c2}}{L_{1}C_{1}L_{2}C_{2}} = V_{m}\sin\left(\omega t + \phi\right) \quad (n.13)$$
ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ : M⁴ + $\left(\frac{1}{L_{1}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{2}}\right)M^{2} + \frac{1}{L_{1}C_{1}L_{2}C_{2}} = 0$

$$M^{2} = \frac{-\left(\frac{1}{L_{1}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{2}}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{1}{L_{1}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{2}}\right)^{2} - \frac{4}{L_{1}C_{1}L_{2}C_{2}}}{2}}{2}$$

$$-2\left(\frac{1}{L_{1}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{1}} + \frac{1}{L_{2}C_{2}}\right) \pm 2\sqrt{\left[\left(\frac{1}{L_{1}C_{1}} - \frac{2}{\sqrt{L_{1}C_{1}L_{2}C_{2}}} + \frac{1}{L_{2}C_{2}}\right) + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right] \times \left[\left(\frac{1}{L_{1}C_{1}} + \frac{2}{\sqrt{L_{1}C_{1}L_{2}C_{2}}} + \frac{1}{L_{2}C_{2}}\right) + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right]}{4}$$

$$M^{2} = \frac{4}{4}$$

$$\omega_{1} = \frac{1}{\sqrt{L_{1}C_{1}}}$$
$$\omega_{2} = \frac{1}{\sqrt{L_{2}C_{2}}}$$

จัดรูปแบบสมการใหม่ได้

$$M^{2} = \frac{-\left[\left(\omega_{1}^{2} + 2\omega_{1}\omega_{2} + \omega_{2}^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right) + \left(\omega_{1}^{2} - 2\omega_{1}\omega_{2} + \omega_{2}^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right)\right]}{4}{-\left(\left(\omega_{1}^{2} - 2\omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2} + \omega_{2}^{2}\right) + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right] \times \left[\left(\omega_{1}^{2} + 2\omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2} + \omega_{2}^{2}\right) + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right]}{4}}{-\left(\left(\omega_{1} + \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right) \times \left[\left(\left(\omega_{1} + \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right) \times - \left(\left(\omega_{1} - \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right)\right]}{4}\right]}$$
$$M^{2} = \frac{4}{4}$$

กำหนดให้

$$A = \sqrt{\left(\left(\omega_1 + \omega_2\right)^2 + \frac{1}{L_2C_1}\right)}$$
$$B = \sqrt{\left(\left(\omega_1 - \omega_2\right)^2 + \frac{1}{L_2C_1}\right)}$$

จัดรูปแบบสมการใหม่ไ<mark>ด้</mark>

$$V_{c} = D_{1} \cos\left(\omega_{d1} t\right) + D_{2} \sin\left(\omega_{d1} t\right) + D_{3} \cos\left(\omega_{d2} t\right) + D_{4} \sin\left(\omega_{d2} t\right)$$
(n.14)

เมื่อ

$$\omega_{d1} = \frac{\sqrt{\left(\omega_{1} + \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}} + \sqrt{\left(\omega_{1} - \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}}}{2}}{\sqrt{\left(\omega_{1} + \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}} - \sqrt{\left(\omega_{1} - \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}}}{2}$$

หาค่าคำตอบเฉพาะใต้โดยนำ V_p = A sin(
$$\omega t + \phi$$
) + Bcos($\omega t + \phi$) แทนในสมการ (ก.13)
A ω^4 sin($\omega t + \phi$) + B ω^4 cos($\omega t + \phi$) +
 $\left(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \frac{1}{L_2C_1}\right) \left[-A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) - B\omega^2 \cos(\omega t + \phi)\right]$
 $+\omega_1^2 \omega_2^2 \left[A \sin(\omega t + \phi) + B \cos(\omega t + \phi)\right] = \omega_1^2 \omega_2^2 V_m \sin(\omega t + \phi)$

จะได้สมการ

$$B\omega^{4} - \left(\omega_{1}^{2} + \omega_{2}^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right)B\omega^{2} + \omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2}B = 0$$
 (n.15)

$$A\omega^{4} - \left(\omega_{1}^{2} + \omega_{2}^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}\right)A\omega^{2} + \omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2}A = \omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2}V_{m}$$
(n.16)

แก้สมการ (ก.15) และ (ก.16) จะได้

$$B = 0$$

$$A = \frac{V_{m}\omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2}}{\left[\left(\omega^{2} - \omega_{1}^{2}\right)\left(\omega^{2} - \omega_{2}^{2}\right) - \omega^{2}/L_{2}C_{1}\right]}$$

ได้ผลคำตอบเฉพาะดังนี้

$$V_{p} = \frac{\omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2}}{\left[\left(\omega^{2} - \omega_{1}^{2}\right)\left(\omega^{2} - \omega_{2}^{2}\right) - \frac{\omega^{2}}{L_{2}C_{1}}\right]}V_{m}\sin(\omega t + \phi)$$

ได้ผลคำตอบของแรงดันเกินสวิตซิ่งที่ C₂ ดังนี้

$$V_{c2}(t) = D_{1}\cos(\omega_{d1}t) + D_{2}\sin(\omega_{d1}t) + D_{3}\cos(\omega_{d2}t) + D_{4}\sin(\omega_{d2}t) + KV_{m}\sin(\omega_{d1}t) + KV_{m}\cos(\omega_{d1}t) + KV_{m}\cos(\omega_{d1}t) + KV_{m}\cos(\omega_{d1}t) + KV_{m}\cos(\omega_{d1}t) + KV_$$

เมื่อ

$$K = \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{\left[\left(\omega^2 - \omega_1^2\right)\left(\omega^2 - \omega_2^2\right) - \frac{\omega^2}{L_2 C_1}\right]}$$

หาผลคำตอบของแรงดันเกินสวิตชิ่งที่ C₁ ดังนี้จากสมการ(ก.10) และ (ก.11)

$$V_{c1}(t) = A \left[D_{1} \cos(\omega_{d1}t) + D_{2} \sin(\omega_{d1}t) \right] + B \left[D_{3} \cos(\omega_{d2}t) + D_{4} \sin(\omega_{d2}t) \right] + EKV_{m} \sin(\omega t + \phi)$$
(n.18)

เมื่อ

$$A = 1 - \frac{\omega_{d1}^2}{\omega_2^2}$$
$$B = 1 - \frac{\omega_{d2}^2}{\omega_2^2}$$
$$E = 1 - \frac{\omega_2^2}{\omega_2^2}$$

หาค่าคงที่ D₁ และ D₃
ที่เวลา t =0 หา V_{c1}ได้ดังนี้
$$V_m \sin \phi = X_L i + V_{c1} และ i = \frac{V_{c1}}{X_c}$$

 $V_m \sin \phi = \omega L_1 \omega C_1 V_{c1} + V_{c1}$
 $V_{c1} = FV_m \sin \phi$

เมื่อ

$$\mathsf{F} = \frac{1}{\left(\omega^2 \mathsf{L}_1 \mathsf{C}_1 + 1\right)}$$

และ V_{c2} = 0

แทนค่า V_{c1} และ V_{c2} ในสมการ(ก.17), (ก.18) จะได้สมการ

$$AD_{1} + BD_{3} + EKV_{m} \sin\phi = FV_{m} \sin\phi \qquad (n.19)$$

$$D_1 + D_3 + KV_m \sin \phi = 0 \tag{1.20}$$

แก้สมการ (ก.19) และ (ก.20) จะได้

$$D_{1} = \frac{V_{m} \sin \phi [F - (E - B)K]}{(A - B)}$$
$$D_{3} = \frac{V_{m} \sin \phi [F - (E - A)K]}{(B - A)}$$
หาค่าคงที่D₂ และ D₄

ที่เวลา t =0 : I_{c1} = C₁ $\frac{dV_{c1}}{dt} = \omega C_1 FV_m \sin \phi$ และ I_{c2} = C₂ $\frac{dV_{c2}}{dt} = 0$ แทนในสมการ(n.17), (n.18) จะได้สมการ

$$C_{1}\left(A\omega_{d1}D_{2} + B\omega_{d2}D_{4} + \omega EKV_{m}\cos\phi\right) = \omega C_{1}FV_{m}\sin\phi \qquad (n.21)$$

$$C_{2}\left(\omega_{d1}D_{2} + \omega_{d2}D_{4} + \omega KV_{m}\cos\phi\right) = 0 \qquad (n.22)$$

แก้สมการ (ก.21) และ (ก.22) จะได้

$$D_{2} = \frac{V_{m}\omega[F\sin\phi - (E - B)K\cos\phi]}{(A - B)\omega_{d1}}$$
$$D_{4} = \frac{V_{m}\omega[F\sin\phi - (E - A)K\cos\phi]}{(B - A)\omega_{d2}}$$

ได้ผลคำตอบของแรงดันเกินสวิตซิ่งดังนี้

$$V_{c1}(t) = A \left[D_1 \cos(\omega_{d1}t) + D_2 \sin(\omega_{d1}t) \right] + B \left[D_3 \cos(\omega_{d2}t) + D_4 \sin(\omega_{d2}t) \right] + EKV_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$V_{c2}(t) = D_{1}\cos(\omega_{d1}t) + D_{2}\sin(\omega_{d1}t) + D_{3}\cos(\omega_{d2}t) + D_{4}\sin(\omega_{d2}t) + KV_{m}\sin(\omega_{t} + \phi)$$

เมื่อ

$$\begin{split} \omega_{1} &= \sqrt[1]{\sqrt{L_{1}C_{1}}} \\ \omega_{2} &= \sqrt[1]{\sqrt{L_{2}C_{2}}} \\ \omega_{d1} &= \frac{\sqrt{\left(\omega_{1} + \omega_{2}\right)^{2} + \sqrt[1]{L_{2}C_{1}} + \sqrt{\left(\omega_{1} - \omega_{2}\right)^{2} + \sqrt[1]{L_{2}C_{1}}}}{2} \\ \omega_{d2} &= \frac{\sqrt{\left(\omega_{1} + \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}} - \sqrt{\left(\omega_{1} - \omega_{2}\right)^{2} + \frac{1}{L_{2}C_{1}}}}{2} \\ K &= \frac{\omega_{1}^{2}\omega_{2}^{2}}{\left[\left(\omega^{2} - \omega_{1}^{2}\right)\left(\omega^{2} - \omega_{2}^{2}\right) - \omega^{2}/L_{2}C_{1}\right]} \\ A &= 1 - \frac{\omega_{d1}^{2}}{\omega_{2}^{2}} \\ B &= 1 - \frac{\omega_{d2}^{2}}{\omega_{2}^{2}} \\ E &= 1 - \frac{\omega_{d2}^{2}}{\omega_{2}^{2}} \\ F &= \frac{1}{\left(\omega^{2}L_{1}C_{1} + 1\right)} \\ D_{1} &= \frac{V_{m}\sin\phi[F - (E - B)K]}{(A - B)} \\ D_{2} &= \frac{V_{m}\omega[F\sin\phi - (E - B)K\cos\phi]}{(A - B)\omega_{d1}} \end{split}$$

$$D_{3} = \frac{V_{m} \sin \phi [F - (E - A)K]}{(B - A)}$$
$$D_{4} = \frac{V_{m} \omega [F \sin \phi - (E - A)K \cos \phi]}{(B - A)\omega_{d2}}$$

หากระแสเกินสวิตชิ่งจาก

$$i_c = C \frac{dv}{dt}$$

จะได้ผลคำตอบของกระแสเกินสวิตชิ่งดังนี้

$$i_{c1}(t) = C_1 A \omega_{d1} \left[D_2 \cos(\omega_{d1} t) - D_1 \sin(\omega_{d1} t) \right] + C_1 B \omega_{d2} \left[D_4 \cos(\omega_{d2} t) - D_3 \sin(\omega_{d2} t) \right] + C_1 E K \omega V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$i_{c2}(t) = C_2 \omega_{d1} \left[D_2 \cos(\omega_{d1}t) - D_1 \sin(\omega_{d1}t) \right] + C_2 \omega_{d2} \left[D_4 \cos(\omega_{d2}t) - D_3 \sin(\omega_{d2}t) \right] + C_2 K \omega V_m \cos(\omega t + \phi)$$

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข.

ข้อมูลที่ใช้ในการจำลอง

BusName	Vbus (kV)	Positive sequence in	mpedance (p.u.)	Zero sequence impedance (p.u.)	
		R1	X1	R0	X0
HHO	230	0	0.17401	0	0.08286
PMN	115	0	0.10765	0	0.08333
SS	115	0.08657	0.19678	0.00738	0.17534
UB1	115	0.16425	0.33879	0.00767	0.18268
SRD	115	0.04826	0.3712	0.0007	0.02168
AN	115	0.05197	0.1196	0.01498	0.13331

ข.1 ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร

ข.2 ค่าซีแควนซ์ของสาย<mark>ส่</mark>ง

	Positive sequence		Zero sequence		Shunt susceptance		Length
BusName	impedance (p.u.)*		impedance (p.u.)*		(p.u.)*		(km)
	R1	X1	R0	X0	Y1	Y0	
UB2-HHO	0.022568	0.171270	0.125325	0.542327	0.338110	0.269076	230.236
UB2-PMN	0.071977	0.205209	0.184375	0.742058	0.026816	0.016694	71
UB2-SS	0.061029	0.173994	0.156329	0.629182	0.022737	0.014155	60.2
UB2-UB1	0.030312	0.086419	0.077645	0.312500	0.011293	0.007030	29.9
UB1-SRD	0.164635	0.193391	0.266288	0.683145	0.022636	0.014211	63.31
UB1-AN	0.167653	0.203495	0.295717	0.633190	0.022160	0.012206	65

*ค่า p.u.เป็นค่าที่คูณระยะทางแล้ว

หมายเหตุ UB1 = UBON RATCHATHANI-1 , UB2 = UBON RATCHATHANI-2 SS = SISAKET ,AN = ANAT CHAROEN ,HHO = HOUAY HO POWER PLANT PMN = PAKMUN POWER PLANT ,SRD = SIRINDHORN POWER PLANT

ข.3 ลักษณะการจัดวางสายส่ง

HHO-UB2



HHO-UB2





SS-UB2



สถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย UB1-SRD



Number of circuit 2 Number of conductor per phase 1

Size 95 SQ. MM ACSR 0.3411 Ω/km 1.36 cm. 10.32 m.

Overhead ground wire

3.8453 Ω/km

0.9144 cm.

Skin = 1.000711

Length 63.31 km. 🕖 AN-UB1



ข.4 ข้อมูลของหม้อแปลง

หม้อแปลง KT3A เป็นหม้อแปลงลดแรงดัน 230/115-22 kV ขนาด 200 MVA ต่อแบบ Yy0(d1) มี ค่า %Z เท่ากับ 13.2% ติดตั้งที่บัส HHO-UB2

หม้อแปลง KT4A เป็นหม้อแปลงลดแรงดัน 230/115-22 kV ขนาด 200 MVA ต่อแบบ Yy0(d1) มี ค่า %Z เท่ากับ 12.6% ติดตั้งที่บัส HHO-UB2

Voltage rating	MCOV Rating	Max. Discharge Voltage kV			
kV-rms	kV-rms	500 A	1000A	2000A	
9	7.65	19.1	19.9	20.9	
12	10.2	25.2	26.3	27.7	
15	12.7	31.4	32.8	34.4	
18	15.3	37.6	39.2	41.2	
21	17	40.4	41.7	43.3	

ข.5 ข้อมูลของกับดักฟ้าผ่า



ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายอรรถพันธ์ จันทสมิต เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2520 จังหวัดกระบี่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2541 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย